

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

Постановление · № 763 · от 08.09.2011 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 763

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 51, ст. 6361; 2009, № 9, ст. 1130).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 сентября 2011 г. № 763

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

1. В паспорте Программы:

а) позицию, касающуюся государственных заказчиков Программы, изложить в следующей редакции:

"Государственные заказчики Программы

-

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное космическое агентство, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";

б) в позиции, касающейся важнейших целевых индикатора и показателей:

в абзаце втором слова "Ожидается, что в 2008 году в организациях микроэлектроники будет освоен технологический уровень 0,18 мкм, что обеспечит" заменить словами "В организациях микроэлектроники в 2008 году освоен технологический уровень 0,18 мкм, что позволило обеспечить";

в абзаце третьем цифры "0,09" заменить цифрами "0,13";

в абзаце пятом цифры "64" заменить цифрами "62", цифры "117" заменить цифрами "114";

в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

в абзаце первом цифры "187000" заменить цифрами "179224,366";

в абзаце втором цифры "110000" заменить цифрами "106844,71", цифры "66000" заменить цифрами

"63908,3", цифры "44000" заменить цифрами "42936,41";

в абзаце третьем цифры "77000" заменить цифрами "72379,656";

г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности:

в абзаце тринадцатом цифры "198577,2" заменить цифрами "203443,4", цифры "125045,9" заменить цифрами "131640";

в абзаце четырнадцатом цифры "2,7" заменить цифрами "2,8".

2. Предложения третье и четвертое абзаца четвертого подраздела, касающегося целевых индикатора и показателей реализации Программы, раздела II заменить текстом следующего содержания: "В результате реализации Программы в 41 организации электронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации будут созданы центры проектирования, а в 96 - осуществлены реконструкция и техническое перевооружение. Кроме того, техническое перевооружение будет осуществлено в одной организации, подведомственной Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. Также к 2015 году центры проектирования будут созданы в 21 организации Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Федерального космического агентства и Министерства образования и науки Российской Федерации, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса, а в 17 - осуществлены реконструкция и техническое перевооружение."

3. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры "187000" заменить цифрами "179224,366";

б) в абзаце втором цифры "110000" заменить цифрами "106844,71";

в) в абзаце третьем цифры "66000" заменить цифрами "63908,3";

г) в абзаце четвертом цифры "44000" заменить цифрами "42936,41";

д) в абзаце пятом цифры "77000" заменить цифрами "72379,656";

е) в абзаце седьмом цифры "33000" заменить цифрами "32500".

4. В абзаце десятом раздела V слова "Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию" заменить словами "Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю".

5. В разделе VI:

а) в абзаце пятом цифры "198577,2" заменить цифрами "203443,4";

б) в абзаце шестом цифры "64374,4" заменить цифрами "64554,9";

в) в абзаце седьмом цифры "125045,9" заменить цифрами "131640";

г) в абзаце девятом цифры "1,52" заменить цифрами "1,54";

д) в абзаце десятом цифры "2,7" заменить цифрами "2,8".

6. Приложения № 1 - 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. № 763)

ИНДИКАТОР И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

Единица измерения

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Индикатор

Достижимый технологический уровень электроники

мкм

0,18

0,18

0,13

0,13

0,09

0,09

0,09

0,09

0,045

Показатели

Увеличение объемов продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники

млрд. рублей

19

58

70

95

130

170

210

250

300

Количество разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы и радиоэлектроники (нарастающим итогом)

-

3-5

16-20

80-90

125-135

179-185

210

230

250

260-270

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Минпромторга России (нарастающим итогом)

-

1
8
10
14
30
30
31
31
42

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Росатома, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)

-
-
-
-
-

1
1
1
4
4

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Роскосмоса, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)

-
-
-
-
-
-

1
3
3
10

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Минобрнауки России, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)

-
-

1
1
2
2
3
5
5

7

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Минпромторга России (нарастающим итогом)

-
-
1
5
8
18
21
25
25
96

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях ФСТЭК России (нарастающим итогом)

-
-
-
-
-
-
1
1
1
1

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Росатома, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)

-
-
-
-
-
-
-
1
1
9

Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Роскосмоса, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)

-
-
-
-
-

-
-
1
1
8

Количество завершенных поисковых технологических научно-исследовательских работ
(нарастающим итогом)

-
1
3
9
9-10
10-12
12-14
14-16
16-18
20-22

Количество реализованных мероприятий по созданию электронной компонентной базы,
соответствующей мировому уровню (типов, классов новой электронной компонентной базы)
(нарастающим итогом)

-
4
11-12
16-20
22-25
36-40
41-45
45-50
50-55
55-60

Количество создаваемых рабочих мест (нарастающим итогом)

-
450
1020- 1050
1800- 2200
3000- 3800
3800- 4100
4100- 4400
4400- 4700
4700- 5000
5000- 6000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Мероприятия

2008 - 2015 годы -

всего

В том числе

Ожидаемые результаты

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Направление 1. Сверхвысокочастотная электроника

1.

Разработка технологии производства мощных сверхвысокочастотных транзисторов на основе гетероструктур материалов группы А В 3 5

128,624

84

66

44

62,624

40

создание базовой технологии производства мощных сверхвысокочастотных транзисторов на основе гетероструктур материалов группы А 3 В 5 для бортовой и наземной аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

2.

Разработка базовой технологии производства монолитных сверхвысокочастотных микросхем и объемных приемо- передающих сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона

208,25

137,7

30,5

20

39,5

26

53,25

35,5
31,8
21,2
53,2
35

создание базовой технологии производства монокристаллических сверхвысокочастотных микросхем и объемных приемопередающих сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона на основе гетероструктур материалов группы АЗВ5 для бортовой и наземной аппаратуры радиолокации, средств связи (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

3.

Разработка базовой технологии производства мощных сверхвысокочастотных полупроводниковых приборов на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур

212,75
134,75
141,75
87,75
71
47

создание технологии производства мощных транзисторов сверхвысокочастотного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур для техники связи, радиолокации (2009 год)

4.

Разработка базовой технологии и библиотеки элементов для проектирования и производства монокристаллических интегральных схем сверхвысокочастотного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур

531
375

20
17
77,5
65
163,5
109
118
80
152
104

создание технологии производства на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур мощных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем с рабочими частотами до 20 ГГц для техники связи, радиолокации (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

5.

Разработка базовой технологии производства сверхвысокочастотных компонентов и сложнофункциональных блоков для сверхвысокочастотных интегральных схем высокой степени

интеграции на основе гетероструктур "кремний - германий"

149,257

101,7

85,757

59,7

63,5

42

создание базовой технологии производства компонентов для сверхвысокочастотных интегральных схем диапазона 2-12 ГГц с высокой степенью интеграции для аппаратуры радиолокации и связи бортового и наземного применения, а также бытовой и автомобильной электроники (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

6.

Разработка базовой технологии производства сверхвысокочастотных интегральных схем высокой степени интеграции на основе гетероструктур "кремний - германий"

248,55

158,1

5,6

5

65,8

35

177,15 118,1

создание базовой технологии производства сверхвысокочастотных интегральных схем диапазона 2-12 ГГц с высокой степенью интеграции для аппаратуры радиолокации и связи бортового и наземного применения, а также бытовой и автомобильной электроники (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

7.

Разработка аттестованных библиотек сложнофункциональных блоков для проектирования сверхвысокочастотных и радиочастотных интегральных схем на основе гетероструктур "кремний - германий"

448,408 308,75

253

169

195,408

139,75

разработка аттестованных библиотек сложнофункциональных блоков для проектирования широкого спектра сверхвысокочастотных интегральных схем на SiGe с рабочими частотами до 150 ГГц, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

8.

Разработка базовых технологий проектирования кремний- германиевых сверхвысокочастотных и радиочастотных интегральных схем на основе аттестованной библиотеки сложнофункциональных блоков

217,44

142

47

30

80,09

52

58,95

39,3

17

11,3

14,4

9,4

создание базовых технологий проектирования на основе библиотеки сложнофункциональных блоков широкого спектра сверхвысокочастотных интегральных схем на SiGe с рабочими частотами до 150 ГГц (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

9.

Разработка базовых технологий производства элементной базы для ряда силовых герметичных модулей высокоплотных источников вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры

114,9

74

60

40

54,9

34

создание базовых технологий производства элементной базы для высокоплотных источников вторичного электропитания сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

10.

Разработка базовых технологий производства ряда силовых герметичных модулей высокоплотных источников вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры

126,913

73,1

79,513

41,5

47,4

31,6

создание базовых конструкций и технологии производства высокоэффективных, высокоплотных источников вторичного электропитания сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры на основе гибридно- пленочной технологии с применением бескорпусной элементной базы (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

11.

Разработка базовых конструкций и технологии производства корпусов мощных сверхвысокочастотных транзисторов X-, C-, S-, L- и P-диапазонов из малотоксичных материалов с высокой теплопроводностью

226

152

151,2

102

74,8

50

создание технологии массового производства ряда корпусов мощных сверхвысокочастотных приборов для "бессвинцовой" сборки (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

12.

Разработка базовых конструкций теплоотводящих элементов систем охлаждения сверхвысокочастотных приборов X- и C-диапазонов на основе новых материалов

83,5

55

13

8

40,5

27

30

20

создание базовых конструктивных рядов элементов систем охлаждения аппаратуры X- и C-диапазонов наземных, корабельных и воздушно- космических комплексов

13.

Разработка базовой технологии производства теплоотводящих элементов систем охлаждения сверхвысокочастотных приборов X- и C-диапазонов на основе новых материалов

109

62

64

32

45

30

создание технологии массового производства конструктивного ряда элементов систем охлаждения аппаратуры X- и C- диапазонов наземных, корабельных и воздушно- космических комплексов (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

14.

Разработка базовых технологий производства суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов S- и L- диапазонов

13

8

13

8

создание технологии массового производства конструктивного ряда сверхвысокочастотных транзисторов S- и L- диапазонов для техники связи, локации и контрольной аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

15.

Разработка конструктивно- параметрического ряда суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов S- и L-диапазонов

208,9

115,9

139,9

69,9

69

46

создание конструктивно- параметрического ряда сверхвысокочастотных транзисторов S- и L- диапазонов для техники связи, локации и контрольной аппаратуры, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

16.

Разработка технологии измерений и базовых конструкций установок автоматизированного измерения параметров нелинейных моделей сверхвысокочастотных полупроводниковых структур, мощных транзисторов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем X-, C-, S-, L- и P- диапазонов для их массового производства

32

22

18

12

14

10

разработка метрологической аппаратуры нового поколения для исследования и контроля параметров полупроводниковых структур, активных элементов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем в производстве и при их использовании

17.

Исследование и разработка базовых технологий для создания нового поколения мощных вакуумно- твердотельных сверхвысокочастотных приборов и гибридных малогабаритных сверхвысокочастотных модулей с улучшенными массогабаритными характеристиками, магнитоэлектрических приборов сверхвысокочастотного диапазона, в том числе циркуляторов и фазовращателей, вентилях, высокодобротных резонаторов, перестраиваемых фильтров, микроволновых приборов со спиновым управлением для перспективных радиоэлектронных систем двойного назначения

149,416

102

84,916

59

64,5

43

создание технологии унифицированных сверхширокополосных приборов среднего и большого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн и сверхвысокочастотных магнитоэлектрических приборов для перспективных радиоэлектронных систем и аппаратуры связи космического базирования (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

18.

Разработка базовых конструкций и технологии производства нового поколения мощных вакуумно-твердотельных сверхвысокочастотных приборов и гибридных малогабаритных сверхвысокочастотных модулей с улучшенными массогабаритными характеристиками, магнитоэлектрических приборов сверхвысокочастотного диапазона, в том числе циркуляторов и фазовращателей, вентилях, высокочастотных резонаторов, перестраиваемых фильтров, микроволновых приборов со спиновым управлением для перспективных радиоэлектронных систем двойного назначения

118,45 85,3

77,5

58

40,95

27,3

разработка конструктивных рядов и базовых технологий производства сверхширокополосных приборов среднего и большого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн и сверхвысокочастотных магнитоэлектрических приборов для перспективных радиоэлектронных систем и аппаратуры связи космического базирования (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

19.

Исследование и разработка процессов и базовых технологий нанопленочных малогабаритных сверхвысокочастотных резисторно-индуктивно-емкостных матриц многофункционального назначения для печатного монтажа и сверхбыстродействующих (до 150 ГГц) приборов на наногетероструктурах с квантовыми дефектами

110,5

75,5

65,5

45,5

45

30

создание технологических процессов производства нанопленочных малогабаритных сверхвысокочастотных резисторно-индуктивно-емкостных матриц многофункционального назначения для печатного монтажа (2008 год), создание базовой технологии получения сверхбыстродействующих (до 150 ГГц) приборов на наногетероструктурах с квантовыми эффектами (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской,

технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

20.

Разработка базовых конструкций и технологии производства нанопленочных малогабаритных сверхвысокочастотных резисторно- индуктивно-емкостных матриц многофункционального назначения для печатного монтажа

84,5

53

50

30

34,5

23

создание конструктивных рядов и базовых технологий производства нанопленочных малогабаритных сверхвысокочастотных резисторно-индуктивно- емкостных матриц многофункционального назначения для печатного монтажа (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

21.

Разработка базовой технологии сверхвысокочастотных p-i-n диодов, матриц, узлов управления и портативных фазированных блоков аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн на основе магнитоэлектронных твердотельных и высокоскоростных цифровых приборов и устройств с функциями адаптации и цифрового диаграммообразования

133,314

88

63,447

42

69,867

46

создание базовой технологии производства элементов и специальных элементов и блоков портативной аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн для нового поколения средств связи, радиолокационных станций, радионавигации, измерительной техники, автомобильных радаров, охранных и сигнальных устройств (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

22.

Разработка базовых технологий создания мощных вакуумных сверхвысокочастотных устройств

2342,933

1540,66

338

230

295,11

193,1

364,823

226,98

380,85

253,9

320

210

189,8

124,8

218,35

145,88

236

156

создание конструктивных рядов и базовых технологий проектирования и производства мощных и сверхмощных вакуумных сверхвысокочастотных приборов для аппаратуры широкого назначения нового поколения (2009 год, 2011 год), включая разработку:

конструкций многолучевых электронно-оптических систем, включая автоэмиссионные катоды повышенной мощности и долговечности (2012 год);

мощных широкополосных ламп бегущей волны импульсного и непрерывного действия, магнетронов, тетродов миллиметрового диапазона (2013 год);

малогабаритных ускорителей электронов с энергией до 10 МэВ для терапевтических и технических приложений (2014 год)

23.

Разработка базовых технологий создания мощных твердотельных сверхвысокочастотных устройств на базе нитрида галлия

1661,182

1096,4

158,001

103

253,012

166,5

296,269

192,4

293,55

195,7

287,35

189,9

118

78,9

112

75

143

95

создание базовых конструкций и технологий изготовления сверхвысокочастотных мощных приборов на структурах с использованием нитрида галлия (2008 год, 2010 год), включая:

создание гетеропереходных полевых транзисторов с диодом Шоттки с удельной мощностью до 30-40 Вт/мм и рабочими напряжениями до 100 В;

исследования и разработку технологий получения гетероструктур на основе слоев нитрида галлия на изоляторе и высокоомных подложках (2013 год);

разработка технологии получения интегральных схем, работающих в экстремальных условиях (2015 год)

24.

Исследование перспективных типов сверхвысокочастотных приборов и структур, разработка технологических принципов их изготовления

1085,2

699,1

160,2

32,8

99,5

224,7

300

147,6

308

170

217,5

124

исследование технологических принципов формирования перспективных сверхвысокочастотных приборов и структур, включая создание наногетероструктур, использование комбинированных (электронных и оптических методов передачи и преобразования сигналов), определение перспективных методов формирования приборных структур, работающих в частотных диапазонах до 200 ГГц

25.

Разработка перспективных методов проектирования и моделирования сложно- функциональной сверхвысокочастотной электронной компонентной базы

1043,3

699,1

49,2

32,8

331,7

224,7

221,4

147,6

255

170

186

124

создание полного состава прикладных программ проектирования и оптимизации сверхвысокочастотной электронной компонентной базы, включая проектирование активных приборов, полосковых линий передачи, согласующих компонентов, формируемых в едином технологическом процессе

Всего по направлению 1

9787,287 6468,08

1485,57 993,95

1392,821 929,35

1375,395 855,78

1603,5

1069

1205,35

804,12
1048,8
700
893,35
595,88
782,5
520

Направление 2. Радиационно стойкая электронная компонентная база

26.

Разработка базовой технологии радиационно стойких сверхбольших интегральных схем уровня 0,5 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм

106,65
79,65
60
38
46,65 41,65

создание технологии изготовления микросхем с размерами элементов 0,5 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм (2009 год), разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем расширенной номенклатуры для организации производства радиационно стойкой элементной базы, обеспечивающей выпуск специальной аппаратуры и систем, работающих в экстремальных условиях (атомная энергетика, космос, военная техника)

27.

Разработка базовой технологии радиационно стойких сверхбольших интегральных схем уровня 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм

286,65
188,1
39,2
19,6
170,25
113,5
53,2
37,2
24
17,8

создание технологии изготовления микросхем с размерами элементов 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм (2013 год), разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем, обеспечивающих создание расширенной номенклатуры быстродействующей и высокоинтегрированной радиационно стойкой элементной базы

28.

Разработка технологии проектирования и конструктивно- технологических решений библиотеки логических и аналоговых элементов, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих устройств, сложно- функциональных радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,25 мкм

245,904
164
130
87
115,904
77

создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой до 0,25 мкм (2009 год)

29.

Разработка технологии проектирования и конструктивно- технологических решений библиотеки логических и аналоговых элементов, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих устройств, сложно- функциональных радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,18 мкм

365,35
235

108,6
54,3
166,05
110,7
67,7
52,6
23
17,4

создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой до 0,18 мкм

30.

Разработка базовых технологических процессов изготовления радиационно стойкой элементной базы для сверхбольших интегральных схем энергозависимой пьезоэлектрической и магниторезистивной памяти с проектными нормами 0,35 мкм и пассивной радиационно стойкой элементной базы

141,75
97,65
92
63
49,75 34,65

создание технологического процесса изготовления сверхбольших интегральных схем энергонезависимой, радиационно стойкой сегнетоэлектрической памяти уровня 0,35 мкм и базовой технологии создания, изготовления и аттестации радиационно стойкой пассивной электронной компонентной базы (2009 год)

31.

Разработка базовых технологических процессов изготовления радиационно стойкой элементной базы для сверхбольших интегральных схем энергозависимой пьезоэлектрической и магниторезистивной памяти с проектными нормами 0,18 мкм и пассивной радиационно стойкой

элементной базы

257,45

159,2

74,6

37,3

130,35

86,9

42,3

28,2

10,2

6,8

создание технологического процесса изготовления сверхбольших интегральных схем энергонезависимой радиационно стойкой сегнетоэлектрической памяти уровня 0,18 мкм (2010 год) и создания, изготовления и аттестации радиационно стойкой пассивной электронной компонентной базы (2013 год)

32.

Разработка технологии "кремний на сапфире" изготовления ряда лицензионно- независимых радиационно стойких комплементарных полевых полупроводниковых сверхбольших интегральных схем цифровых процессоров обработки сигналов, микроконтроллеров и схем интерфейса

110,736

73

58,609

38

52,127

35

разработка расширенного ряда цифровых процессоров, микроконтроллеров, оперативных запоминающих программируемых и перепрограммируемых устройств, аналого-цифровых преобразователей в радиационно стойком исполнении для создания специальной аппаратуры нового поколения

33.

Разработка технологии структур с ультратонким слоем кремния на сапфире

370,802

231,7

82,952

39,8

190,35

126,9

72,6

48,4

24,9

16,6

создание технологии проектирования и изготовления микросхем и сложнофункциональных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире", позволяющей разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости (2013 год)

34.

Разработка базовой технологии и приборно- технологического базиса производства радиационно стойких сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", радиационно стойкой силовой электроники для аппаратуры питания и управления

92,669

73,15

51

40

41,669

33,15

разработка конструкции и модели интегральных элементов и технологического маршрута изготовления радиационно стойких сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" с расширенным температурным диапазоном, силовых транзисторов и модулей для бортовых и промышленных систем управления с пробивными напряжениями до 75 В и рабочими токами коммутации до 10 А (2009 год)

35.

Разработка элементной базы радиационно стойких интегральных схем на основе полевых эмиссионных микронанотриодов

74,471

50,6

36,2

26,1

38,271

24,5

создание ряда микронанотриодов и микронанодиодов с наивысшей радиационной стойкостью для долговечной аппаратуры космического базирования

36.

Создание информационной базы радиационно стойкой электронной компонентной базы, содержащей модели интегральных компонентов, функционирующих в условиях радиационных воздействий, создание математических моделей стойкости электронной компонентной базы, создание методик испытаний и аттестации электронной компонентной базы

256,6

167,3

21,4

10,7

25

16,6

92,4

61,6

117,8

78,4

разработка комплекса моделей расчета радиационной стойкости электронной компонентной базы для определения технически обоснованных норм испытаний

37.

Разработка библиотек стандартных элементов и сложнофункциональных блоков для создания

радиационно стойких сверхбольших интегральных схем

975,5

650

105

70

184,5

123

281,5

187,5

209, 5

139,5

195

130

создание технологии проектирования и изготовления микросхем и сложнофункциональных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире", позволяющей разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости (2012 год, 2015 год)

38.

Разработка расширенного ряда радиационно стойких сверхбольших интегральных схем для специальной аппаратуры связи, обработки и передачи информации, систем управления

978,75

650

187,5

125

185

123

163

108,5

242,75

160

200,5

133,5

разработка расширенного ряда цифровых процессоров, микроконтроллеров, оперативных запоминающих программируемых и перепрограммируемых устройств, аналого-цифровых преобразователей в радиационно стойком исполнении для создания специальной аппаратуры нового поколения, разработка конструкции и модели интегральных элементов и технологического маршрута изготовления радиационно стойких сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" с расширенным температурным диапазоном, силовых транзисторов и модулей для бортовых и промышленных систем управления с пробивными напряжениями до 75 В и рабочими токами коммутации до 10 А, создание ряда микронанотриодов и микронанотриодов с наивысшей радиационной стойкостью для долговечной аппаратуры космического базирования

39.

Разработка и совершенствование методов моделирования и проектирования радиационно стойкой элементной базы

953

634

75

50

275

183

230

153,5

196

130,5

177

117

разработка комплекса моделей расчета радиационной стойкости электронной компонентной базы для определения технически обоснованных норм испытаний

40.

Разработка и совершенствование базовых технологий и конструкций радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на структурах "кремний на сапфире" и "кремний на изоляторе" с топологическими нормами не менее 0,18 мкм

988,15

650

180

120

191

123

177,5

113,5

233,65

160

206

133,5

создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой не менее 0,18 мкм (2014 год), создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой не менее 0,18 мкм (2015 год)

Всего по направлению 2

6204,432

4103,35

427,809

292,1

344,371

245,95

326,752

161,7

1229,5

819,6

1163,7

780

1051,9
700
881,9
590
778,5
514

Направление 3. Микросистемная техника

41.

Разработка базовых технологий микроэлектромеханических систем

184,215
117,9
165,053
105,9
19,162
12

создание базовых технологий (2009 год) и комплектов технологической документации на изготовление микроэлектромеханических систем контроля давления, микроакселерометров с чувствительностью по двум и трем осям, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактюаторов

42

Разработка базовых конструкций микроэлектромеханических систем

433,712
273,8
87,239
42,1
73,473
49,7
108
72
82,5
55
82,5
55

разработка базовых конструкций и комплектов необходимой конструкторской документации на изготовление чувствительных элементов и микросистем контроля давления, микроакселерометров, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактюаторов с напряжением управления, предназначенных для использования в транспортных средствах, оборудовании топливно-энергетического комплекса, машиностроении, медицинской технике, робототехнике, бытовой технике

43

Разработка базовых технологий микроакустоэлектромеханических систем

166,784
108,15
122,356
78,55

44,428

29,6

создание базовых технологий (2009 год) и комплектов необходимой технологической документации на изготовление микроакустоэлектромеханических систем, основанных на использовании поверхностных акустических волн (диапазон частот до 2 ГГц) и объемно- акустических волн (диапазон частот до 8 ГГц), пьезокерамических элементов, совместимых с интегральной технологией микроэлектроники

44.

Разработка базовых конструкций микроакустоэлектромеханических систем

244,325

147,3

52

28

103,825

60,3

88,5

59

разработка базовых конструкций и комплектов необходимой конструкторской документации на изготовление пассивных датчиков физических величин микроакселерометров, микрогироскопов на поверхностных акустических волнах, датчиков давления и температуры, датчиков деформации, крутящего момента и микроперемещений, резонаторов

45.

Разработка базовых технологий микроаналитических систем

37

25

37

25

создание базовых технологий изготовления элементов микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства, в медицинской и биомедицинской технике для обнаружения токсичных, горючих и взрывчатых материалов

46.

Разработка базовых конструкций микроаналитических систем

134

78

47

20

60

40

27

18

создание базовых конструкций микроаналитических систем, предназначенных для аппаратуры жилищно- коммунального хозяйства, медицинской и биомедицинской техники;
разработка датчиков и аналитических систем миниатюрных размеров с высокой чувствительностью

к сверхмалым концентрациям химических веществ для осуществления мониторинга окружающей среды, контроля качества пищевых продуктов и контроля утечек опасных и вредных веществ в технологических процессах

47.

Разработка базовых технологий микрооптоэлектромеханических систем

42,444

27

15,358

10,2

27,086

16,8

создание базовых технологий выпуска трехмерных оптических и акустооптических функциональных элементов, микрооптоэлектромеханических систем для коммутации и модуляции оптического излучения, акустооптических перестраиваемых фильтров, двухмерных управляемых матриц микрозеркал, микропереключателей и фазовращателей (2009 год)

48.

Разработка базовых конструкций микрооптоэлектромеханических систем

109,278 70

33,95

21

48,328

31

27

18

разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление микрооптоэлектромеханических систем коммутации и модуляции оптического излучения

49.

Разработка базовых технологий микросистем анализа магнитных полей

55,008

36

55,008

36

создание базовых технологий изготовления микросистем анализа магнитных полей на основе анизотропного и гигантского магниторезистивного эффектов, квазимонолитных и монолитных гетеромагнитных пленочных структур (2008 год)

50.

Разработка базовых конструкций микросистем анализа магнитных полей

153,518

98,018

39,518

22,018

93

62

21

разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на магниточувствительные микросистемы для применения в электронных системах управления приводами, в датчиках положения и потребления, бесконтактных переключателях

51.

Разработка базовых технологий радиочастотных микроэлектромеханических систем

123,525

80,662

43,274

28,45

80,251

52,212

разработка и освоение в производстве базовых технологий изготовления радиочастотных микроэлектромеханических систем и компонентов, включающих микрореле, коммутаторы, микропереключатели (2009 год)

52.

Разработка базовых конструкций радиочастотных микроэлектромеханических систем

142,577

96

35,6

25

63,477

42

43,5

29

разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление радиочастотных микроэлектромеханических систем - компонентов, позволяющих получить резкое улучшение массогабаритных характеристик, повышение технологичности и снижение стоимости изделий

53.

Разработка методов и средств обеспечения создания и производства изделий микросистемной техники

38,915

22,8

38,915

22,8

создание методов и средств контроля и измерения параметров и характеристик изделий микросистемотехники, разработка комплектов стандартов и нормативных документов по безопасности и экологии

54.

Разработка перспективных технологий и конструкций микрооптоэлектромеханических систем для оптической аппаратуры, систем отображения изображений, научных исследований и специальной техники

1155

770

345

230

315

210

270

180

225

150

создание базовых технологий выпуска трехмерных оптических и акустооптических функциональных элементов, микрооптоэлектромеханических систем для коммутации и модуляции оптического излучения (2012 год), акустооптических перестраиваемых фильтров (2012 год), двухмерных управляемых матриц микрозеркал микропереключателей и фазовращателей (2013 год), разработка базовых технологий, конструкций и комплектов, конструкторской документации на изготовление микрооптоэлектромеханических систем коммутации и модуляции оптического излучения (2015 год)

55.

Разработка и совершенствование методов и средств контроля, испытаний и аттестации изделий микросистемотехники

1140

760

150

100

262,5

175

232,5

155

270

180

225

150

создание методов и средств контроля и измерения параметров и характеристик изделий микросистемотехники, разработка комплектов стандартов и нормативных документов по безопасности и экологии

56.

Разработка перспективных технологий и конструкций микроаналитических систем для аппаратуры контроля и обнаружения токсичных, горючих, взрывчатых и наркотических веществ

1170

780

360

240

315

210

255

170

240

160

создание перспективных технологий изготовления элементов микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства (2012 год, 2013 год, 2014 год)

Всего по направлению 3

5330,301 3490,63

476,964

306,9

466,233 268,73

442,103

285

465

310

1050

700

945

630

795

530

690

460

Направление 4. Микроэлектроника

57.

Разработка технологии и развитие методологии проектирования изделий микроэлектроники: разработка и освоение современной технологии проектирования универсальных микропроцессоров, процессоров обработки сигналов, микроконтроллеров и "системы на кристалле" на основе каталогизированных сложнофункциональных блоков и библиотечных элементов, в том числе создание отраслевой базы данных и технологических файлов для автоматизированных систем проектирования; освоение и развитие технологии проектирования для обеспечения технологичности производства и стабильного выхода годных изделий с целью размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,13 мкм

308,667

178,4

219,3

129,5

89,36 7

48,9

разработка комплекта нормативно-технической документации по проектированию изделий микроэлектроники, создание отраслевой базы данных с каталогами библиотечных элементов и сложно- функциональных блоков с каталогизированными результатами аттестации на физическом уровне, разработка комплекта нормативно-технической и технологической документации по взаимодействию центров проектирования в сетевом режиме

58.

Разработка и освоение базовой технологии производства фотошаблонов с технологическим уровнем до 0,13 мкм с целью обеспечения информационной защиты проектов изделий микроэлектроники при

использовании контрактного производства (отечественного и зарубежного)

34,569 22,7

22,7

14,7

11,869

8

разработка комплекта технологической документации и организационно-распорядительной документации по взаимодействию центров проектирования и центра изготовления фотошаблонов

59.

Разработка семейств и серий изделий микроэлектроники: универсальных микропроцессоров для встроенных применений; универсальных микропроцессоров для серверов и рабочих станций; цифровых процессоров обработки сигналов; сверхбольших интегральных схем, программируемых логических интегральных схем; сверхбольших интегральных схем быстродействующей динамической и статической памяти; микроконтроллеров со встроенной энергонезависимой электрически программируемой памятью; схем интерфейса дискретного ввода/вывода; схем аналогового интерфейса; цифроаналоговых и аналого- цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 8-12 бит; схем приемопередатчиков шинных интерфейсов; изделий интеллектуальной силовой микроэлектроники для применения в аппаратуре промышленного и бытового назначения; встроенных интегральных источников питания

852,723

490,2

350,836

190,1

501,887

300,1

разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, изготовление опытных образцов изделий и организация серийного производства

60.

Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: цифроаналоговых и аналого- цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 14 - 16 бит; микроэлектронных устройств различных типов, включая сенсоры с применением наноструктур и биосенсоров; сенсоров на основе магнитоэлектрических и пьезоматериалов; встроенных интегральных антенных элементов для диапазонов частот 5 ГГц, 10-12 ГГц; систем на кристалле, в том числе в гетероинтеграции сенсорных и исполнительных элементов методом беспроводной сборки с применением технологии матричных жестких выводов

2236,828

1299

1129,878 592,3

971,95

616,7

135

90

разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, изготовление опытных образцов изделий и организация серийного производства

61.

Разработка технологии и освоение производства изделий микроэлектроники с технологическим уровнем 0,13 мкм

545,397

308,8

304,9

168,3

240,497

140,5

разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической документации и ввод в эксплуатацию производственной линии

62.

Разработка базовой технологии формирования многослойной разводки (7-8 уровней) сверхбольших интегральных схем на основе Al и Si

939,45

587,3

196

102

360

240

154

99

229,45

146,3

разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

63.

Разработка технологии и организация производства многокристальных микроэлектронных модулей для мобильных применений с использованием полимерных и металлополимерных микроплат и носителей

519,525

288,9

235,513

101

168,512

110,9

115,5

77

разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской,

технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

64.

Разработка новых методов технологических испытаний изделий микроэлектроники, гарантирующих их повышенную надежность в процессе долговременной (более 100 000 часов) эксплуатации, на основе использования типовых оценочных схем и тестовых кристаллов

133,8

133,8

67

67

66,8

66,8

разработка технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию специализированных участков

65.

Разработка современных методов анализа отказов изделий микроэлектроники с применением ультраразрешающих методов (ультразвуковая гигагерцовая микроскопия, сканирование синхротронным излучением, атомная и туннельная силовая микроскопия, электронно- и ионно-лучевое зондирование и другие)

243,77

243,77

131,9

131,9

111,87

111,87

разработка комплектов документации, включая утвержденные отраслевые методики, ввод в эксплуатацию модернизированных участков и лабораторий анализа отказов

66.

Разработка базовых субмикронных технологий уровней 0,065 - 0,045 мкм

1240,5

800

310

200

380

245

310

200

240,5

155

создание технологии сверхбольших интегральных схем;

создание базовой технологии формирования многослойной разводки сверхбольших интегральных схем топологического уровня 0,065 - 0,045 мкм (2015 год), освоение и развитие технологии проектирования и изготовления для обеспечения технологичности производства и стабильного выхода годных изделий, а также с целью размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,045 мкм, разработка комплекта технологической документации и организационно- распорядительной документации по взаимодействию центров

67.

Исследование технологических процессов и структур для субмикронных технологий уровней 0,032 мкм
1424,45 915,7

383

245

383,45

245,7

368

235

290

190

создание технологии сверхбольших интегральных схем технологических уровней 65-45 нм,
организация опытного производства и исследование технологических уровней 0,032 мкм (2015 год)

68.

Разработка перспективных технологий и конструкций изделий интеллектуальной силовой
электроники для применения в аппаратуре бытового и промышленного применения, на транспорте,
в топливно- энергетическом комплексе и в специальных системах

1479,55

959,7

166,0 5

110,7

402,7

261,8

355

230

317,5

205

238,3

152,2

создание технологий и конструкций перспективных изделий интеллектуальной силовой
микроэлектроники для применения в аппаратуре промышленного и бытового назначения;
создание встроенных интегральных источников питания (2013 - 2015 годы)

69.

Разработка перспективных технологий сборки сверхбольших интегральных схем в многовыводные
корпуса, в том числе корпуса с матричным расположением выводов и технологий многокристальной
сборки, включая создание "систем в корпусе"

1730,6

1100

300

200

356,4

224,2

205

123

455

290

414,2

262,8

разработка перспективной технологии многокристалльных микроэлектронных модулей для мобильных применений с использованием полимерных и металлополимерных микроплат и носителей (2015 год)

Всего по направлению 4

11689,829

7328,27

1096,636

701,5

1257,803

777,17

1494,39 805,2

1913,5

1244,4

1741,1

1120

1552,9

990

1450,5

930

1183

760

Направление 5. Электронные материалы и структуры

70.

Разработка технологии производства новых диэлектрических материалов на основе ромбоэдрической модификации нитрида бора и подложек из поликристаллического алмаза

78

49

51

32

27

17

внедрение новых диэлектрических материалов на основе ромбоэдрической модификации нитрида бора и подложек из поликристаллического алмаза с повышенной теплопроводностью и электропроводностью для создания нового поколения высокоэффективных и надежных сверхвысокочастотных приборов

71.

Разработка технологии производства гетероэпитаксиальных структур и структур гетеробиполярных транзисторов на основе нитридных соединений А В 3 5 для мощных полупроводниковых приборов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем

93,663

54,24

46,233

22,62
47,43
31,62

создание технологии производства гетероэпитаксиальных структур и структур гетеробиполярных транзисторов на основе нитридных соединений А В 3 5 для обеспечения разработок и изготовления сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем и мощных транзисторов (2011 год)

72.

Разработка базовой технологии производства метаморфных структур на основе GaAs и псевдоморфных структур на подложках InP для приборов сверхвысокочастотной электроники диапазона 60-90 ГГц

78,047
49,8
50,147 32
27,9
17,8

создание базовой технологии производства гетероструктур и псевдоморфных структур на подложках InP для перспективных полупроводниковых приборов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем диапазона 60-90 ГГц (2009 год)

73.

Разработка технологии производства спинэлектронных магнитных материалов, радиопоглощающих и мелкодисперсных ферритовых материалов для сверхвысокочастотных приборов

132,304
82
33,304
16
45
30
54
36

создание спинэлектронных магнитных материалов и микроволновых структур со спиновым управлением для создания перспективных микроволновых сверхвысокочастотных приборов повышенного быстродействия и низкого энергопотребления

74.

Разработка технологии производства высокочистых химических материалов (аммиака, арсина, фосфина, тетрахлорида кремния) для обеспечения производства полупроводниковых подложек нитрида галлия, арсенида галлия, фосфида индия, кремния и гетероэпитаксиальных структур на их основе

76,4
47,3
50,1
31
26,3
16,3

создание технологии массового производства высокочистых химических материалов (аммиака,

арсина, фосфина, тетрахлорида кремния) для выпуска полупроводниковых подложек нитрида галлия, арсенида галлия, фосфида индия, кремния и гетероэпитаксиальных структур на их основе (2009 год)

75.

Разработка технологии производства поликристаллических алмазов и их пленок для теплопроводных конструкций мощных выходных транзисторов и сверхвысокочастотных приборов

62,07

45,38

12

12

35,07

23,38

15

10

создание технологии производства поликристаллических алмазов и его пленок для мощных сверхвысокочастотных приборов (2012 год)

76.

Исследование путей и разработка технологии изготовления новых микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и металлодиэлектрических микро- и наноструктур, а также полупроводниковых нитей с наноразмерами при вытяжке стеклянного капилляра, заполненного жидкой фазой полупроводника

57

38

36

24

21

14

создание технологии изготовления новых микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и металлодиэлектрических микро- и наноструктур для новых классов микроструктурных приборов, магниторезисторов, осцилляторов, устройств оптоэлектроники (2009 год)

77.

Разработка технологии выращивания слоев пьезокерамики на кремниевых подложках для формирования комплексированных устройств микросистемной техники

64,048

39

4,5

3

32,548

18

27

18

создание базовой пленочной технологии пьезокерамических элементов, совместимой с комплементарной металлооксидной полупроводниковой технологией для разработки нового класса активных пьезокерамических устройств, интегрированных с микросистемами (2011 год)

78.

Разработка методологии и базовых технологий создания многослойных кремниевых структур с использованием "жертвенных" и "стопорных" диффузионных и диэлектрических слоев для производства силовых приборов и элементов микроэлектромеханических систем

63,657

38

42,657

24

21

14

создание технологии травления и изготовления кремниевых трехмерных базовых элементов микроэлектромеханических систем с использованием "жертвенных" и "стопорных" слоев для серийного производства элементов микроэлектромеханических систем (2009 год) кремниевых структур с использованием силикатных стекол, моно-, поликристаллического и пористого кремния и диоксида кремния

79.

Разработка базовых технологий получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий с широким диапазоном функциональных свойств

45,85

22

29,35

11

16,5

11

создание технологии получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий, алмазных полупроводящих пленок для конкурентоспособных высокотемпературных и радиационно стойких устройств и приборов двойного назначения (2011 год)

80.

Исследование и разработка технологии роста эпитаксиальных слоев карбида кремния, структур на основе нитридов, а также формирования изолирующих и коммутирующих слоев в приборах экстремальной электроники

136,716

88,55

57,132

38

79,584

50,55

создание технологии изготовления гетероструктур и эпитаксиальных структур на основе нитридов для создания радиационно стойких сверхвысокочастотных и силовых приборов нового поколения (2009 год)

81.

Разработка технологии производства радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на ультратонких гетероэпитаксиальных структурах кремния на сапфировой подложке для производства электронной компонентной базы специального и двойного назначения

159,831

90

52

35

107,831

55

создание технологии производства структур "кремний на сапфире" диаметром до 150 мм с толщиной приборного слоя до 0,1 мкм и топологическими нормами до 0,18 мкм для производства электронной компонентной базы специального и двойного назначения (2009 год)

82.

Разработка технологии производства высокоомного радиационно облученного кремния, слитков и пластин кремния диаметром до 150 мм для производства силовых полупроводниковых приборов

138,549

89,7

54

36

84,549

53,7

создание технологии производства радиационно облученного кремния и пластин кремния до 150 мм для выпуска мощных транзисторов и сильноточных тиристоры нового поколения (2009 год)

83.

Разработка технологии производства кремниевых подложек и структур для силовых полупроводниковых приборов с глубокими высоколегированными слоями р- и n-типов проводимости и скрытыми слоями носителей с повышенной рекомбинацией

90,4

58,9

38,5

24

51,9

34,9

разработка и промышленное освоение получения высококачественных подложек и структур для использования в производстве силовых полупроводниковых приборов, с глубокими высоколегированными слоями и скрытыми слоями носителей с повышенной рекомбинацией (2009 год)

84.

Разработка технологии производства электронного кремния, кремниевых пластин диаметром до 200 мм и кремниевых эпитаксиальных структур уровня технологии 0,25 - 0,18 мкм

220,764

162

73,964

48

146,8

114

создание технологии производства пластин кремния диаметром до 200 мм и эпитаксиальных структур уровня 0,25 - 0,18 мкм (2009 год)

85.

Разработка методологии, конструктивно- технических решений и перспективной базовой технологии корпусирования интегральных схем и полупроводниковых приборов на основе использования многослойных кремниевых структур со сквозными токопроводящими каналами

266,35

161

81,85

38

124,5

83

30

20

30

20

разработка технологии корпусирования интегральных схем и полупроводниковых приборов на основе использования многослойных кремниевых структур со сквозными токопроводящими каналами, обеспечивающей сокращение состава сборочных операций и формирование трехмерных структур (2013 год)

86.

Разработка технологии производства гетероструктур SiGe для разработки сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм

230,141

143

35,141

13

135

90

30

20

30

20

создание базовой технологии производства гетероструктур SiGe для выпуска быстродействующих сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм (2011 год, 2013 год)

87.

Разработка технологии выращивания и обработки, в том числе плазмохимической, новых пьезоэлектрических материалов для акустоэлектроники и акустооптики

46,745

34

28,745

22

18

12

создание технологии выращивания и обработки пьезоэлектрических материалов акустоэлектроники и акустооптики для обеспечения производства широкой номенклатуры акустоэлектронных устройств нового поколения (2009 год)

88.

Разработка технологий производства соединений А В и тройных 3 5 структур для: производства сверхмощных лазерных диодов; высокоэффективных светодиодов белого, зеленого, синего и ультрафиолетового диапазонов; фотоприемников среднего инфракрасного диапазона

93,501

58

24,001

12

33

22

23

15

13,5

9

создание технологии массового производства исходных материалов и структур для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной техники, в том числе: производства сверхмощных лазерных диодов (2010 год); высокоэффективных светодиодов белого, зеленого, синего и ультрафиолетового диапазонов (2011 год); фотоприемников среднего инфракрасного диапазона (2013 год)

89.

Исследование и разработка технологии получения гетероструктур с вертикальными оптическими резонаторами на основе квантовых ям и квантовых точек для производства вертикально излучающих лазеров для устройств передачи информации и матриц для оптоэлектронных переключателей нового поколения

45,21

30

30,31

22

14,9

8

создание технологии производства принципиально новых материалов полупроводниковой электроники на основе сложных композиций для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной техники (2009 год)

90.

Разработка технологии производства современных компонентов для специализированных фотоэлектронных приборов, в том числе: катодов и газопоглотителей; электронно-оптических и отклоняющих систем; стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок

32,305

17

24,805

12

7,5

5

создание технологии производства компонентов для специализированных электронно-лучевых (2010 год), электронно-оптических и отклоняющих систем (2010 год), стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок (2011 год)

91.

Разработка технологии производства особо тонких гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для высокоэффективных фотокатодов, электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного диапазона и солнечных элементов с высокими значениями коэффициента полезного действия

39,505

32

27,505

20

12

12

создание технологии производства особо тонких гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для изготовления высокоэффективных фотокатодов электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного диапазона, солнечных элементов и других приложений (2009 год)

92.

Разработка базовой технологии производства монокристаллов AlN для изготовления изолирующих и проводящих подложек для гетероструктур

42,013

24

24,013

12

18

12

создание технологии монокристаллов AlN для изготовления изолирующих и проводящих подложек для создания полупроводниковых высокотемпературных и мощных сверхвысокочастотных приборов нового поколения (2011 год)

93.

Разработка базовой технологии производства наноструктурированных оксидов металлов (корунда и т. п.) для производства вакуумно-плотной нанокерамики, в том числе с заданными оптическими свойствами

44,559

29,2

29,694

19,85

14,905

9,35

создание базовой технологии вакуумно-плотной спецстойкой керамики из нанокристаллических порошков и нитридов металлов для промышленного освоения спецстойких приборов нового поколения (2009 год), в том числе микрочипов, сверхвысокочастотных аттенюаторов, RLC-матриц, а также особо прочной электронной компонентной базы оптоэлектроники и фотоники

94.

Разработка базовой технологии производства полимерных и гибридных органо-неорганических наноструктурированных защитных материалов для электронных компонентов нового поколения прецизионных и сверхвысокочастотных резисторов, терминаторов, аттенюаторов и резисторно-

индукционно- емкостных матриц, стойких к воздействию комплекса специальных внешних факторов

25,006

13

22,006

11

3

2

создание технологии производства полимерных и композиционных материалов с использованием поверхностной и объемной модификации полимеров наноструктурированными наполнителями для создания изделий с высокой механической, термической и радиационной стойкостью при работе в условиях длительной эксплуатации и воздействии комплекса специальных внешних факторов (2011 год)

95.

Исследование и разработка перспективных гетероструктурных и наноструктурированных материалов с экстремальными характеристиками для перспективных электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры специального назначения

1395,5

930

225

150

269

179

309

206

322,5

215

270

180

создание базовой технологии производства гетероструктур, структур и псевдоморфных структур на подложках InP для перспективных полупроводниковых приборов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем диапазона 60-90 ГГц (2012 год), создание технологии получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий (2013 год), алмазных полупроводящих пленок для конкурентоспособных высокотемпературных и радиационно стойких устройств и приборов двойного назначения, создание технологии изготовления гетероструктур и эпитаксиальных структур на основе нитридов (2015 год)

96.

Исследование и разработка экологически чистых материалов и методов их использования в производстве электронной компонентной базы и радиоаппаратуры, включая бессвинцовые композиции для сборки

1395

930

435

290

382,5

255

277,5

185

300

200

создание нового класса конструкционных и технологических материалов для уровней технологии 0,065 - 0,032 мкм и обеспечения высокого процента выхода годных изделий, экологических требований по международным стандартам (2012 год, 2015 год)

97.

Разработка перспективных технологий получения ленточных материалов (полимерные, металлические, плакированные и другие) для радиоэлектронной аппаратуры и сборочных операций электронной компонентной базы

1379

920

404

270

367,5

245

307,5

205

300

200

создание перспективных технологий производства компонентов для специализированных электронно-лучевых, электронно-оптических и отклоняющих систем, стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок (2013 год), создание технологии производства полимерных и композиционных материалов с использованием поверхностной и объемной модификации полимеров наноструктурированными наполнителями (2015 год)

Всего по направлению 5

6532,174

4275,07

621,754

407,85

658,169

431,6

365,251

177,62

717

478

1260

840

1132,5

755

907,5

605

870

580

Направление 6. Группы пассивной электронной компонентной базы

98.

Разработка технологии выпуска прецизионных температуро-стабильных высокочастотных до 1,5 - 2 ГГц резонаторов на поверхностно акустических волнах до 1,5 ГГц с полосой до 70 процентов и длительностью сжатого сигнала до 2-5 нс

30,928

20

18

12

12,928

8

разработка расширенного ряда резонаторов с повышенной кратковременной и долговременной стабильностью для создания контрольной аппаратуры и техники связи двойного назначения

99.

Разработка в лицензируемых и нелицензируемых международных частотных диапазонах 860 МГц и 2,45 ГГц ряда радиочастотных пассивных и активных акустоэлектронных меток- транспондеров, в том числе работающих в реальной помеховой обстановке, для систем радиочастотной идентификации и систем управления доступом

78,5

45

32

14

33

22

13,5

9

создание технологии и конструкции акустоэлектронных пассивных и активных меток-транспондеров для применения в логистических приложениях на транспорте, в торговле и промышленности (2010 год, 2011 год)

100.

Разработка базовой конструкции и промышленной технологии производства пьезокерамических фильтров в корпусах для поверхностного монтажа

30,5

19,5

17

11

13,5

8,5

создание технологии проектирования и базовых конструкций пьезоэлектрических фильтров в малогабаритных корпусах для поверхностного монтажа при изготовлении техники связи массового применения (2009 год)

101.

Разработка технологии проектирования, базовой технологии производства и конструирования акустоэлектронных устройств нового поколения и фильтров промежуточной частоты с высокими характеристиками для современных систем связи, включая высокоизбирательные высокочастотные устройства частотной селекции на поверхностных и приповерхностных волнах и волнах Гуляева-

Блюштейна с предельно низким уровнем вносимого затухания для частотного диапазона до 5 ГГц
37,73
23
37,73
23

создание базовой технологии акустоэлектронных приборов для перспективных систем связи, измерительной и навигационной аппаратуры нового поколения: подвижных, спутниковых, тропосферных и радиорелейных линий связи, цифрового интерактивного телевидения, радиоизмерительной аппаратуры, радиолокационных станций, спутниковых навигационных систем (2008 год)

102.

Разработка технологии проектирования и базовой технологии производства функциональных законченных устройств стабилизации, селекции частоты и обработки сигналов типа "система в корпусе"

97,416
60,9

35,001 22
62,415
38,9

создание технологии производства высокоинтегрированной электронной компонентной базы типа "система в корпусе" для вновь разрабатываемых и модернизируемых сложных радиоэлектронных систем и комплексов (2010 год)

103.

Разработка базовой конструкции и технологии изготовления высокочастотных резонаторов и фильтров на объемных акустических волнах для телекоммуникационных и навигационных систем

63
42
21
14
21
14
21
14

создание базовой технологии и базовой конструкции микроминиатюрных высокочастотных фильтров для малогабаритной и носимой аппаратуры навигации и связи (2013 год)

104.

Разработка технологии и базовой конструкции фоточувствительных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для видимого и ближнего инфракрасного диапазона для аппаратуры контроля изображений

35
23
35
23

создание нового поколения оптоэлектронных приборов для обеспечения задач предотвращения

аварий и контроля

105.

Разработка базовой технологии унифицированных электронно- оптических преобразователей, микроканальных пластин, пироэлектрических матриц и камер на их основе с чувствительностью до 0,1 К и широкого инфракрасного диапазона

35,309

21,9

16,009

10

19,3

11,9

создание базовой технологии нового поколения приборов контроля тепловых полей для задач теплоэнергетики, медицины, поисковой и контрольной аппаратуры на транспорте, продуктопроводах и в охранных системах (2009 год)

106.

Разработка базовой технологии создания интегрированных гибридных фотоэлектронных высокочувствительных и высокоразрешающих приборов и усилителей для задач космического мониторинга и специальных систем наблюдения, научной и метрологической аппаратуры

82

53

45

30

37

23

создание базовой технологии (2008 год) и конструкции новых типов приборов, сочетающих фотоэлектронные и твердотельные технологии, с целью получения экстремально достижимых характеристик для задач контроля и наблюдения в системах двойного назначения

107.

Разработка базовых технологий мощных полупроводниковых лазерных диодов (непрерывного и импульсного излучения), специализированных лазерных полупроводниковых диодов, фотодиодов и лазерных волоконно- оптических модулей для создания аппаратуры и систем нового поколения

96,537

64

48,136

30

48,401

34

создание базовой технологии (2008 год) и конструкций принципиально новых мощных диодных лазеров, предназначенных для широкого применения в изделиях двойного назначения, медицины, полиграфического оборудования и системах открытой оптической связи

108.

Разработка и освоение базовых технологий для лазерных навигационных приборов, включая интегральный оптический модуль лазерного гироскопа на базе сверхмалогабаритных кольцевых полупроводниковых лазеров инфракрасного диапазона, оптоэлектронные компоненты для широкого класса инерциальных лазерных систем управления движением гражданских и специальных средств

транспорта

56,5

37

16

10

30

20

10,5

7

разработка базового комплекта основных оптоэлектронных компонентов для лазерных гироскопов широкого применения (2010 год), создание комплекса технологий обработки и формирования структурных и приборных элементов, оборудования контроля и аттестации, обеспечивающих новый уровень технико- экономических показателей производства

109.

Разработка базовых конструкций и технологий создания квантово- электронных приемопередающих модулей для малогабаритных лазерных дальномеров нового поколения на основе твердотельных чип-лазеров с полупроводниковой накачкой, технологических лазерных установок широкого спектрального диапазона

22

15

22

15

создание базовой технологии твердотельных чип-лазеров для лазерных дальномеров, твердотельных лазеров с пикосекундными длительностями импульсов для установок по прецизионной обработке композитных материалов, для создания элементов и изделий микромашиностроения и в производстве электронной компонентной базы нового поколения, мощных лазеров для применения в машиностроении, авиастроении, автомобилестроении, судостроении, в составе промышленных технологических установок обработки и сборки, систем экологического мониторинга окружающей среды, контроля выбросов патогенных веществ, контроля утечек в продуктопроводах (2008 год, 2009 год)

110.

Разработка базовых технологий формирования конструктивных узлов и блоков для лазеров нового поколения и технологии создания полного комплекта электронной компонентной базы для производства лазерного устройства определения наличия опасных, взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ в контролируемом пространстве

66,305

43

56,27

37

10,035

6

создание технологии получения широкоапертурных элементов на основе алюмоиттриевой легированной керамики композитных составов для лазеров с диодной накачкой (2008 год), высокоэффективных преобразователей частоты лазерного излучения, организация промышленного выпуска оптических изделий и лазерных элементов широкой номенклатуры

111.

Разработка базовых технологий, базовой конструкции и организация производства интегрированных катодолюминесцентных и других дисплеев двойного назначения со встроенным микроэлектронным управлением

35

35

17

17

18

18

разработка расширенной серии низковольтных катодолюминесцентных и других дисплеев с широким диапазоном эргономических характеристик и свойств по условиям применения для информационных и контрольных систем

112.

Разработка технологии и базовых конструкций высокояркостных светодиодов и индикаторов основных цветов свечения для систем подсветки в приборах нового поколения

38,354

29

23,73

16

14,624

13

создание ряда принципиально новых светоизлучающих приборов с минимальными геометрическими размерами, высокой надежностью и устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям, обеспечивающих энергосбережение за счет замены ламп накаливания в системах подсветки аппаратуры и освещения

113.

Разработка базовой технологии и конструкции оптоэлектронных приборов (оптроны, оптореле, светодиоды) в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа

100,604

59

21,554

10

61,05

37

18

12

создание базовой технологии производства нового поколения оптоэлектронной высокоэффективной и надежной электронной компонентной базы для промышленного оборудования и систем связи (2010 год, 2011 год)

114.

Разработка схемотехнических решений и унифицированных базовых конструкций и технологий формирования твердотельных видеомодулей на полупроводниковых светоизлучающих структурах для носимой аппаратуры, экранов индивидуального и коллективного пользования с бесшовной стыковкой

51,527
33,5
24
16
27,527
17,5

создание технологии новых классов носимой и стационарной аппаратуры, экранов отображения информации коллективного пользования повышенной емкости и формата (2009 год)

115.

Разработка базовой технологии изготовления высокоэффективных солнечных элементов на базе использования кремния, полученного по "бесхлоридной" технологии и технологии "литого" кремния прямоугольного сечения

57,304
37
31,723
20
25,581
17

создание технологии массового производства солнечных элементов для индивидуального и коллективного использования в труднодоступных районах, развития солнечной энергетики в жилищно- коммунальном хозяйстве для обеспечения задач энергосбережения (2009 год)

116

Разработка базовой технологии и освоение производства оптоэлектронных реле с повышенными техническими характеристиками для поверхностного монтажа

32
19
18
12
14
7

создание технологии массового производства нового класса оптоэлектронных приборов для широкого применения в радиоэлектронной аппаратуре (2009 год)

117.

Комплексное исследование и разработка технологий получения новых классов органических (полимерных) люминофоров, пленочных транзисторов на основе "прозрачных" материалов, полимерной пленочной основы и технологий изготовления крупноформатных гибких и особо плоских экранов, в том числе на базе высокоразрешающих процессов струйной печати и непрерывного процесса изготовления типа "с катушки на катушку"

136,7
71,8

50
22
63
34
23,7

15,8

создание базовой технологии массового производства экранов с предельно низкой удельной стоимостью для информационных и обучающих систем (2010 год, 2011 год)

118.

Разработка базовых конструкций и технологии активных матриц и драйверов плоских экранов на основе аморфных, поликристаллических и кристаллических кремниевых интегральных структур на различных подложках и создание на их основе перспективных видеомодулей, включая органические электролюминесцентные, жидкокристаллические и катодолюминесцентные, создание базовой технологии серийного производства монолитных модулей двойного назначения

145,651

100,5

45

30

13,526

8,5

87,125

62

создание технологии и конструкции активно- матричных органических электролюминесцентных, жидкокристаллических и катодолюминесцентных дисплеев, стойких к внешним специальным и климатическим воздействиям (2010 год)

119.

Разработка базовой конструкции и технологии крупноформатных полноцветных газоразрядных видеомодулей

85,004

46

41,004

10

20

20

24

16

создание технологии и базовых конструкций полноцветных газоразрядных видеомодулей специального и двойного назначения для наборных экранов коллективного пользования (2010 год)

120.

Разработка технологии сверхпрецизионных резисторов и гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на их основе в металлокерамических корпусах для аппаратуры двойного назначения

63,249

42

24,013

16

18,027

12

21,209

14

разработка расширенного ряда сверхпрецизионных резисторов, гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого- цифровых преобразователей с параметрами, превышающими уровень существующих отечественных и зарубежных изделий, для аппаратуры связи, диагностического контроля, медицинского оборудования, авиастроения, станкостроения, измерительной техники (2010 год)

121.

Разработка базовой технологии особо стабильных и особо точных резисторов широкого диапазона номиналов, прецизионных датчиков тока для измерительной и контрольной аппаратуры и освоение их производства

75

50

30

20

30

20

15

10

разработка расширенного ряда сверхпрецизионных резисторов с повышенной удельной мощностью рассеяния, высоковольтных высокоомных резисторов для измерительной техники, приборов ночного видения и аппаратуры контроля (2013 год)

122.

Разработка технологии и базовых конструкций резисторов и резистивных структур нового поколения для поверхностного монтажа, в том числе резисторов с повышенными характеристиками, ультранизкоомных резисторов, малогабаритных подстроечных резисторов, интегральных сборок серии нелинейных полупроводниковых резисторов в многослойном исполнении чип-конструкции

149,319

100,2

10,5

7

18,519

13

24,75

16,5

45

30

50,55

33,7

создание базовой технологии и конструкции резисторов с повышенными значениями стабильности, удельной мощности в чип-исполнении на основе многослойных монокристаллических структур (2010 год, 2013 год)

123.

Разработка технологий формирования интегрированных резистивных структур с повышенными технико- эксплуатационными характеристиками на основе микроструктурированных материалов и методов групповой сборки

46,93

30,95
36,001
24
10,929
6,95

создание базовой технологии производства датчиков на резистивной основе с высокими техническими характеристиками и надежностью (2009 год)

124.

Создание групповой технологии автоматизированного производства толсто пленочных чип- и микрочип- резисторов

59,011
39
30,006
20
29,005
19

создание технологии автоматизированного производства чип- и микрочип-резисторов (в габаритах 0402, 0201 и менее) для применения в массовой аппаратуре (2009 год)

125.

Разработка новых базовых технологий и конструктивных решений изготовления танталовых оксидно-полупроводниковых и оксидно- электролитических конденсаторов и чип-конденсаторов и организация производства конденсаторов с повышенным удельным зарядом, сверхнизким значением внутреннего сопротивления и улучшенными потребительскими характеристиками

126
83
24
16
27
17
75
50

создание базовой технологии производства конденсаторов с качественно улучшенными характеристиками с электродами из неблагородных металлов при сохранении высокого уровня надежности (2010 год)

126.

Разработка комплексной базовой технологии и организация производства конденсаторов с органическим диэлектриком и повышенными удельными характеристиками и ионисторов с повышенным током разряда

29,801
18
22,277
13
7,524
5

создание базовых технологий конденсаторов и ионисторов на основе полимерных материалов с

повышенным удельным зарядом и энергоемких накопительных конденсаторов с повышенной удельной энергией (2009 год)

127.

Разработка технологии, базовых конструкций высоковольтных (быстродействующих, мощных) вакуумных выключателей нового поколения с предельными характеристиками для радио-технической аппаратуры с высокими сроками службы

94,006

62

23,5

15

39,006

26

31,5

21

создание технологии и базовых конструкций нового поколения выключателей для радиоэлектронной аппаратуры с повышенными тактико-техническими характеристиками и надежностью (2011 год)

128.

Разработка технологий создания газонаполненных высоковольтных высокочастотных коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей с повышенными техническими характеристиками

50,599

33,5

24,803

16,5

25,796 17

создание технологии изготовления коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей в широком диапазоне напряжений и токов для радиоэлектронных и электротехнических систем (2009 год)

129.

Разработка полного комплекта электронной компонентной базы для создания модульного устройства грозозащиты зданий и сооружений с обеспечением требований по международным стандартам

26,5

17,5

26,5

17,5

создание технологии выпуска устройств грозозащиты в индивидуальном, промышленном и гражданском строительстве, строительстве пожароопасных объектов (2008 год)

130.

Разработка базовых конструкций и технологий изготовления малогабаритных переключателей с повышенными сроками службы для печатного монтажа

55

37

46

31
9
6

создание базовой технологии формирования высококачественных гальванических покрытий, технологии прецизионного формирования изделий для автоматизированных систем изготовления коммутационных устройств широкого назначения (2009 год)

131.

Комплексное исследование и разработка пленочных технологий изготовления высокоэкономичных крупноформатных гибких и особо плоских экранов

825

550

80,55

53,7

181

121

224,95

150,3

195

130

143,5

95

комплексное исследование и разработка технологий получения новых классов органических светоизлучающих диодов (ОСИД), полимерной пленочной основы и технологий изготовления гибких ОСИД-экранов, в том числе на базе высокоразрешающих процессов струйной печати, процессов наноимпринта и рулонной технологии изготовления (2013 год);

создание базовой технологии производства ОСИД-экранов для применения в различных системах (2015 год)

132.

Исследование перспективных конструкций и технологических принципов формирования оптоэлектронных и квантовых структур и приборов нового поколения

798

532

75

50

217,5

145

168

112

195

130

142,5

95

создание технологии формирования нового поколения оптоэлектронных комплексированных приборов, обеспечивающих создание "системы на кристалле" с оптическими входами- выходами (2014 год, 2015 год)

133.

Разработка перспективных технологий промышленного изготовления солнечных высокоэффективных элементов

811,5

541

255

170

247,5

165

180

120

129

86

создание перспективной технологии массового производства солнечных элементов для индивидуального и коллективного использования (2015 год)

Всего по направлению 6

4623,784

3034,25

688,198

456

611,262 365,35

510,324

336,9

352,5

235

749,5

500

727

485

570

380

415

276

Направление 7. Унифицированные электронные модули и базовые несущие конструкции

134.

Разработка базовых технологий создания рядов приемо-передающих унифицированных электронных модулей для аппаратуры связи, радиолокации, телекоммуникаций, бортовых радиотехнических средств

4355,463

2911,4

130,715

90,1

167,733

113,6

127,015

87,7

630
420
1058
691
814
553
726
486
702
470

создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной элементной базы и последних достижений в разработке алгоритмов сжатия видеоизображений приемо-передающих унифицированных электронных модулей аппаратуры связи, телекоммуникаций, цифрового телевидения, бортовых радиотехнических средств, активных фазированных антенных решеток с параметрами:

диапазон частот до 100 ГГц;

скорость передачи информации до 100 Гбит/с;

создание базовых технологий и конструкции для создания унифицированных рядов приемо-передающих унифицированных электронных модулей аппаратуры волоконно-оптических линий связи когерентных, высокоскоростных каналов со спектральным уплотнением, телекоммуникаций, цифрового телевидения, обеспечивающих импортозамещение в этой области;

разработка новых технологий

135.

Разработка базовых технологий создания нового класса унифицированных электронных модулей для обработки аналоговых и цифровых сигналов на основе устройств функциональной электроники, приборов обработки сигналов аналого- цифровых и цифроаналоговых преобразователей, сенсоров и преобразователей

2916,849

1932,4

91,404

61,1

159,155

104,9

101,29

56,4

465

310

797

540

555

365

353

233

395

262

создание на основе базовых технологий и современной отечественной твердотельной компонентной электронной базы унифицированных электронных модулей нового поколения для обработки аналоговых и цифровых сигналов РЛС и других радио- технических систем в высокочастотных, ПЧ и

сверхвысокочастотных диапазонах, освоение производства нового класса multifunctional радиозлектронных устройств, разработка унифицированных электронных модулей преобразователей физических и химических величин для измерения и контроля широкой номенклатуры параметров микромеханических систем

136.

Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных модулей для систем телеметрии, управления, навигации (угловых и линейных перемещений, ориентации, стабилизации, позиционирования, наведения, радиопеленгации, единого времени)

1748,445

1160,25

47,185

32,5

77,477

42,2

63,783

45,55

285

190

453

313

300

197

257

167

265

173

создание рядов унифицированных электронных модулей для систем телеметрии, управления, радиолокационных, робототехнических, телекоммуникационных систем и навигации (ориентации, стабилизации, позиционирования, наведения, радиопеленгации, единого времени), позволяющих резко снизить стоимость и организовать крупносерийное производство радиозлектронных средств широкого применения

137.

Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных модулей процессоров, скоростного и сверхскоростного ввода-вывода данных, шифрования и дешифрования данных, интерфейсов обмена, систем сбора и хранения информации, периферийных устройств, систем идентификации и управления доступом, конверторов, информационно-вычислительных систем

3227,159

2145,54

60,024

40

89,053

53,5

63,082

42,04

540

360

977

658

525

348

495

328

478

316

создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной базы унифицированных электронных модулей широкой номенклатуры для применения в различных информационных системах, в том числе унифицированных электронных модулей шифрования и дешифрования данных; разработка базовых технологий и конструкций унифицированных электронных модулей на поверхностных акустических волнах систем радиочастотной и биометрической идентификации, систем идентификации личности, транспортных средств, электронных паспортов, логистики, контроля доступа на объекты повышенной безопасности, объектов атомной энергетики. В создаваемых унифицированных электронных модулях будет обеспечена скорость обмена и передачи информации до 30 Гб/с

138.

Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных цифровых модулей для перспективных магистрально-модульных архитектур

1710,136

1132,4

49,076

32,7

64,824

43,2

81,236

46,5

270

180

437

303

302

197

256

167

250

163

разработка на основе перспективных отечественных сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" базового ряда электронных модулей для создания перспективных магистрально-модульных архитектур, обеспечивающих создание защищенных средств вычислительной техники нового поколения (автоматизированные рабочие места, серверы, средства высокоскоростных линий волоконной связи), функционирующих с использованием современных высокоскоростных последовательных и параллельных системных интерфейсов

139.

Разработка базовых технологий создания ряда унифицированных электронных модулей для контрольно-измерительной, метрологической и поверочной аппаратуры, аппаратуры тестового

контроля, диагностики блоков радиоэлектронной аппаратуры, для стандартных и встроенных систем контроля и измерений

2026,225

1338,2

72,091

35,5

92,753

61,9

61,381

40,8

330

220

536

364

336

224

303

198

295

194

создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной базы рядов унифицированных электронных модулей, обеспечивающих возможность создания по модульному принципу контрольно-измерительной, метрологической и поверочной аппаратуры, аппаратуры тестового контроля и диагностики на основе базовых несущих конструкций; создание комплекта сложнофункциональных блоков, определяющих ядро измерительных приборов, систем и комплексов, разработка законченных функциональных модулей, предназначенных для выполнения процессорных и интерфейсных функций поверки и диагностики сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" для систем управления, а также систем проектирования и изготовления модулей систем управления и бортовых электронно-вычислительных машин, систем обработки информации и вычислений

140.

Разработка базовых технологий создания нового поколения унифицированных рядов средств электропитания и преобразователей электроэнергии для радио- электронных систем и аппаратуры гражданского и двойного назначения

2869,94

1908

58,5

41

95,178

62

91,262

55

480

320

860

574

417

278

477

318

391

260

разработка базовых технологий создания системообразующих унифицированных рядов средств (систем, источников, сервисных устройств) и преобразователей электроэнергии нового поколения межвидового и межведомственного применения, в том числе средств электропитания с высокой плотностью упаковки элементов с применением бескорпусных изделий, плоскихмоточных изделий пленочной технологии, новых методов экранирования, отвода и рассеяния тепла, основанных на применении наноразмерных материалов с высокой анизотропной теплопроводностью.

Будут разработаны базовые технологии создания: унифицированных рядов источников электропитания;

преобразователей электрической энергии;

источников и систем бесперебойного электропитания;

фильтров сетевых модулей автоматического переключения каналов;

модулей защиты от сетевых помех;

адаптеров

141.

Разработка оптимизированной системы базовых несущих конструкций первого, второго и третьего уровней для наземной, морской, авиационной и космической радиоэлектронной аппаратуры специального и двойного назначения, предназначенной для жестких условий эксплуатации, в том числе работающей в негерметизированном отсеке с использованием прогрессивных технологий

3142,225

2089,5

43

28

84,225

54,5

90

57

525

350

920

612

514

343

498

333

468

312

разработка системы базовых несущих конструкций, изготавливаемых на основе прогрессивных технологий и обеспечивающих техническую совместимость со всеми видами современных объектов с использованием новых полимерных материалов. Применение оптимизированных базовых несущих конструкций позволит сократить сроки разработки радиоэлектронной аппаратуры в 1,2 раза, снизить трудоемкость изготовления базовых несущих конструкций в 1,5 - 2 раза, на 25 процентов уменьшить материалоемкость и сократить затраты на производство радиоэлектронной аппаратуры в 1,2 - 1,3 раза, обеспечить эффективное импортозамещение

142.

Разработка базовых технологий комплексно интегрированных базовых несущих конструкций с функциями контроля, диагностики, индикации функционирования

1732,889

1159,68

46,16

33

66,651

45,3

60,078

41,38

285

190

482

320

275

184

269

180

249

166

разработка базовых несущих конструкций с функциями контроля, в том числе контроля температуры, влажности, задымления в корпусах радиоэлектронной аппаратуры, уровня вибрации, контроля параметров составных частей радиоэлектронной аппаратуры - унифицированных электронных модулей, индикации рабочих режимов и аварийных сигналов для идентификации контролируемых параметров, разработка герметичных и перфорированных базовых несущих конструкций, обеспечивающих нормальный тепловой режим радиоэлектронной аппаратуры и выполняющих функции измерения и регулирования в требуемом диапазоне температуры и влажности воздуха внутри герметичных и перфорированных базовых несущих конструкций. Это позволит в 1,5 - 2 раза повысить надежность радиоэлектронной аппаратуры

143.

Разработка базовых технологий создания облегченных паяных базовых несущих конструкций для радиоэлектронной аппаратуры авиационного и космического базирования на основе существующих и перспективных алюминиевых сплавов повышенной прочности, обеспечивающих отвод тепла по элементам конструкции

1287,818

856,2

30,618

20

34,2

22,2

38

24

210

140

362

240

206

138

202

135

205

137

обеспечение улучшения массогабаритных характеристик бортовой аппаратуры на 30 процентов и повышение прочности при внешних воздействиях в 1,5 - 2 раза

144.

Разработка контейнерных базовых несущих конструкций с унифицированными интерфейсными средствами для комплексирования бортовых и наземных систем и комплексов различного назначения

1051,4

698,4

21

14

32,4

20,4

38

24

180

120

275

180

181

123

164

110

160

107

повышение уровня системной интеграции и комплексирования средств и систем, повышение конкурентоспособности не менее чем в 2 раза, обеспечение функционирования аппаратуры в условиях внешних жестких воздействий

Всего по направлению 7

26068,549 17331,97

649,773

427,9

963,649

623,7

815,127

520,37

4200

2800

7157

4795

4425

2950

4000

2655
3858
2560

Направление 8. Типовые базовые технологические процессы

145.

Разработка технологии изготовления высокоплотных теплонагруженных и сильноточных печатных плат

3141,625

2094

45

30

75,057

50

66,568

44

555

370

848

575

553

365

521

345

478

315

обеспечение разработки технологий: производства печатных плат 5-го и выше классов точности, включая платы со встроенными пассивными элементами;

создания межслойных соединений с переходными сопротивлениями до 1 мОм для силовых цепей электропитания;

формирования слоев меди (в том числе с толщиной до 200-400 мкм), серебра, никеля с высокими показателями проводимости;

формирования финишных покрытий для бессвинцовой технологии производства изделий;

производства многослойных печатных плат под высокие температуры пайки;

лазерных процессов изготовления печатных плат;

прямой металлизации сквозных и глухих отверстий

146.

Разработка технологии изготовления прецизионных коммутационных плат на основе керамики (в том числе низко- температурной), металла, углепластика и других функциональных материалов

2012,052

1343,3

35,733

25

52,195

35

49,124

33,3

360

240

545

363

348

232

322

215

300

200

обеспечение разработки технологий:

изготовления коммутационных плат для жестких условий эксплуатации и широкого диапазона частот;

получения коммутационных плат с температурным коэффициентом расширения, соответствующим тепловым характеристикам многовыводных корпусов (в том числе керамических) современных приборов;

обеспечения предельно минимального газовыделения в замкнутом пространстве герметичных модулей;

снижения энергоемкости технологических процессов за счет применения прогрессивных материалов и методов обработки, в том числе низкотемпературной керамики;

интеграции в коммутационную плату теплостоков и низкоомных проводников, пассивных элементов; прогрессивных методов формообразования элементов коммутационных плат;

обеспечения совмещенного монтажа компонентов методами пайки и сварки на одной плате

147.

Разработка технологий сборки, монтажа электронных модулей, многокристальных модулей и микросборок на основе новой компонентной базы, перспективных технологических и конструкционных материалов

3705,145

2460,6

65,121

43

107,805

63

67,219

44,6

615

410

1033

689

668

445

600

400

549

366

обеспечение разработки технологий:

новых методов присоединения, сварки, пайки, в том числе с применением бессвинцовых припоев; высокоточного дозирования материалов, применяемых при сборке (флюсы, припои и припойные пасты, клеи, лаки, компаунды и т. п.);

новых методов сборки и пайки корпусов типа BGA, CSP, Flip-chip и других на различные коммутационные платы;
монтажа новой электронной компонентной базы, в том числе бескорпусных кристаллов силовых ключей на токовые шины;
сборки и монтажа низкопрофильных магнитных компонентов;
настройки и ремонта сложных модулей, в том числе демонтажа и повторного монтажа многовыводных компонентов с восстановлением влагозащиты

148.

Разработка технологии создания межблочных соединений для коммутации сигналов в широком диапазоне частот и мощностей

1392

927

29

19

36,5

24

36,5

24

225

150

382

255

248

165

225

150

210

140

обеспечение разработки технологий: изготовления антенно- фидерных устройств, в том числе гибких волноводов, вращающихся сочленений с различными видами охлаждения;
оптоволоконной коммутации, устойчивой к воздействию жестких условий эксплуатации для различных условий применения, в том числе для систем дистанционного управления и мониторинга;
изготовления устройств коммутации (разъемов, переключателей и т. п.) различного назначения, в том числе многовыводных, герметичных, врубных, сильноточных и других

149.

Разработка методов, средств и технологии автоматизированного контроля коммутационных плат, узлов, электронных модулей и приборов специального и общего применения на этапах разработки и производства

1433,792

955,5

35,154

23

61,38

41

47,258

31,5

225

150

382

255

248

165

225

150

210

140

повышение процента выхода годных изделий, снижение потерь на 15-30 процентов;

обеспечение разработки: неразрушающих методов контроля качества монтажных соединений и многослойных структур за счет использования различного излучения и цифровой обработки информации;

методов выявления напряженных состояний элементов конструкции и потенциальных неисправностей изделий;

унифицированных методов и средств тестового и функционального контроля изделий различного назначения

150.

Разработка технологии производства специальных технологических и конструкционных материалов и базовой технологии защиты электронных модулей от воздействия в жестких условиях эксплуатации

3587,206

2388,12

57,178

36

81,504

53,15

73,524

48,97

600

400

1037

658

642

428

592

395

504

369

импортозамещение специальных конструкционных и технологических материалов, обеспечивающих процессы бессвинцовой и комбинированной пайки, изготовления коммутационных плат;

разработка влагозащитных электроизоляционных покрытий с минимальным газовыделением со сроком эксплуатации 25 и более лет;

разработка быстроотверждающихся, эластичных, с низким газовыделением в вакууме клеев, компаундов;

разработка материалов и технологии их применения для формирования теплостоков в высокоплотной аппаратуре;

разработка высокоэффективных ферритов для планарных трансформаторов повышенной мощности;

обеспечение разработки технологий:

локальной защиты чувствительных компонентов, общей защиты модулей органическими материалами, в том числе наноструктурированными;

вакуумно-плотной герметизации узлов и блоков со свободным внутренним объемом до 5-10 л методами пайки и сварки;

изготовления вакуумно-плотных корпусов многокристальных модулей и микросборок под поверхностный монтаж на платы;

формирования покрытий, обеспечивающих длительную защиту от дестабилизирующих факторов внешней среды, включая ионизирующие излучения;

нанесения локальных покрытий с заданными свойствами на элементы конструкции модулей

Всего по направлению 8

15271,82

10168,52

267,186

176

414,441

266,15

340,193

226,37

2580

1720

4227

2795

2707

1800

2485

1655

2251

1530

Направление 9. Развитие технологий создания радиоэлектронных систем и комплексов

151.

Разработка технологий создания систем и оборудования автоматизации проектирования радиоэлектронных систем и комплексов

2630,515

1751

60,032

40

89,083

59

81,4

52

435

290

887

590

367

245

359

240

352

235

создание технологий отечественного программно- аппаратного обеспечения и средств разработки для автоматизированного проектирования радиоэлектронного оборудования с использованием различных технологических процессов;

повышение качества и сокращение сроков разработки радиоэлектронной продукции;

создание технологий обеспечения информационной безопасности функционирования информационно-управляющих систем;

существенное повышение уровней защиты информации в информационно- управляющих системах,

создание базовых универсальных функциональных модулей защиты информации от несанкционированного доступа, вирусных атак, средств разведки и считывания информации, криптозащиты каналов систем;

реализация полного технологического цикла проектирования, испытаний и производства

унифицированной высокоэффективной, импортозамещающей, конкурентоспособной аппаратуры

152.

Разработка технологий моделирования сложных информационно- управляющих систем, в том числе систем реального времени

3098,994

2052,9

75,3

49,8

138,5

80

80,194

53,1

525

350

1055

705

430

286

406

270

389

259

создание новых способов моделирования:

комбинированного способа моделирования, позволяющего существенным образом повысить быстродействие вычислений при сохранении точности расчета выходных показателей эффективности;

способа операционно- динамического моделирования;

снижение сроков разработки и испытаний радиоэлектронной продукции;

повышение достоверности математического и имитационного моделирования радиоэлектронных систем и комплексов, обеспечение максимальной сходимости результатов с результатами натурных испытаний и экспериментов

153.

Разработка технологий полунатурных и стендовых испытаний сложных информационно-управляющих систем

2425,733

1615,65

45,054

30

70,65

45,65

75,029

50

405

270

975

650

285

190

285

190

285

190

создание метрологически аттестованной унифицированной стендовой испытательной базы для проведения научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ;

снижение сроков разработки и стоимости испытаний радиоэлектронной продукции;

существенное повышение достоверности полунатурного моделирования радиоэлектронных систем и комплексов, обеспечение максимальной сходимости результатов с результатами натурных испытаний

154.

Разработка технологии конструирования и производства, а также аппаратно- программного обеспечения метрологических систем различного назначения для создания нового поколения отечественного парка измерительной аппаратуры

2257,66

1502,61

45,05

30

73,65

48,65

68,96

43,96

375

250

907

605

269

179

270

180

249

166

разработка базовых технологий, элементов и конструкций для создания парка измерительных систем и приборов, необходимых для разработки и испытаний радиотехнических информационно-управляющих систем, систем связи и телекоммуникаций

Всего по направлению 9

10412,902

6922,16

225,436

149,8

371,883

233,3

305,583

199,06

1740

1160

3824

2550

1351

900

1320

880

1275

850

Направление 10. Обеспечивающие работы

155.

Разработка организационных принципов и научно- технической базы обеспечения проектирования и производства электронной компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации

92

89

9

6

6

6

7

7

10

10

18

18

14

14

14

14

14

14

разработка комплекта методической и научно-технической документации для обеспечения функционирования систем проектирования и производства электронной компонентной базы в

соответствии с требованиями Всемирной торговой организации

156.

Создание и обеспечение функционирования системы испытаний электронной компонентной базы, обеспечивающей поставку изделий с гарантированной надежностью для комплектации систем специального и двойного назначения

128,3

125

16,3

13

20

20

13

13

19

19

18

18

14

14

14

14

14

14

разработка новых и совершенствование существующих методов испытаний электронной компонентной базы, разработка методов отбраковочных испытаний перспективной электронной компонентной базы, обеспечение поставки изделий с гарантированной надежностью для комплектации систем специального назначения (атомная энергетика, космические программы, транспорт, системы двойного назначения)

157.

Разработка и совершенствование методов, обеспечивающих качество и надежность сложно-функциональной электронной компонентной базы на этапах опытно- конструкторских работ, освоения и производства

100,5

99

8,5

7

12

12

9

9

11

11

18

18

15

15

14

14

13

13

разработка и систематизация методов расчетно- экспериментальной оценки показателей надежности электронной компонентной базы, разрешенной для применения в аппаратуре, функционирующей в специальных условиях и с длительными сроками активного существования

158.

Создание и внедрение основополагающих документов по обеспечению жизненного цикла изделия на этапах проектирования, производства, применения и утилизации электронной компонентной базы

94,5

86

10

7

14,5

9

10

10

18

18

15

15

14

14

13

13

разработка системы технологий обеспечения жизненного цикла изделия при создании широкой номенклатуры электронной компонентной базы

159.

Научное сопровождение Программы, в том числе определение технологического и технического уровней развития отечественной и импортной электронной компонентной базы на основе их рубежных технико- экономических показателей, разработка "маршрутных карт" развития групп электронной компонентной базы

138

127

19

13

25

20

15

15

19

19

18

18

15

15

14

14

13

13

оптимизация состава выполняемых комплексов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию электронной компонентной базы в рамках Программы и определение перспективных направлений создания новых классов электронной компонентной базы с установлением системы технико-экономических и рубежных технологических показателей, разработка "маршрутных карт" развития по направлениям электронной компонентной базы

160

Создание интегрированной информационно-аналитической автоматизированной системы по развитию электронной компонентной базы, охватывающей деятельность заказчика-координатора, заказчиков и организаций, участвующих в выполнении комплекса программных мероприятий, с целью оптимизации состава участников, финансовых средств, перечисляемой государству прибыли и достижения заданных технико-экономических показателей разрабатываемой электронной компонентной базы

104,5

98

11

7

14,5

12

9

9

10

10

18

18

15

15

14

14

13

13

проведение технико-экономической оптимизации выполнения комплексных годовых мероприятий подпрограммы, создание системы действенного финансового и технического контроля выполнения Программы

161.

Определение перспектив развития российской электронной компонентной базы на основе Влияния динамики сегментов мирового и отечественного рынков радиоэлектронной продукции и действующей производственно-технологической базы

100

93

11

7

13

10

8

8	
8	
8	
18	
18	
15	
15	
14	
14	
13	
13	формирование системно- ориентированных материалов по экономике, технологиям проектирования и производству электронной компонентной базы, обобщение и анализ мирового опыта для выработки технически и экономически обоснованных решений развития электронной компонентной базы
162.	
	Системный анализ результатов выполнения комплекса мероприятий Программы на основе создания отраслевой системы планирования и учета развития разработки, производства и применения электронной компонентной базы по основным технико- экономическим показателям
74	
69	
11	
8	
13	
11	
8	
8	
7	
7	
14	
14	
7	
7	
7	
7	
7	
7	создание отраслевой системы учета и планирования развития разработки, производства и применения электронной компонентной базы
	Всего по направлению 10
831,8	
786	
95,8	
68	
118	
100	
69	

69
94
94
140
140
110
110
105
105
100
100

Итого по разделу I

96752,876
63908,3
6035,127
3980
6598,632
4241,3
6044,117
3637
14895
9930
22517,65 15024,12
15051,1
10020
13408,25
8925,88
12203
8150

Мероприятия

2008 - 2015 годы - всего

В том числе

Сроки реализации

Площадь объекта

(кв. м)

Ожидаемые результаты

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

II. Капитальные вложения

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

163.

Реконструкция и техническое перевооружение производства сверхвысокочастотной техники федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область

744,5

696,5

357

315

191,5

191,5

196

190

2008- 2010

5293

создание производственно- технологического комплекса по выпуску твердотельных сверхвысокочастотных субмодулей мощностью 100 тыс. шт. в год

164.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Пульсар", г. Москва

815,5

580,5

124,5

110

170,5

170,5

100,5

90

420

210

2008- 2011

3424,4

создание производственной технологической линии по выпуску сверхвысокочастотных приборов и модулей на широкозонных полупроводниках мощностью 360 тыс. шт. в год

165.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород

233

140*

53

50

180

90

2010- 2011

3380

расширение мощностей по производству активных элементов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем с повышенной радиационной стойкостью с 15 до 35 тыс. шт. в год**

166.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов

193,6

140*

93,6

90

100

50

2010- 2011

3058,73

ввод новых мощностей по производству новейших образцов ламп бегущей волны и других сверхвысокочастотных приборов, в том числе в миллиметровом диапазоне**

167.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Торий", г. Москва

348,8

200*

78,8

65

270

135

2010- 2011

1438

реконструкция производственной линии по выпуску новых сверхмощных сверхвысокочастотных приборов с повышенным уровнем технических параметров, надежности и долговечности мощностью 88 шт. в год**

168.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ", г. Новосибирск

100

60*

40

30

60

30

2010- 2011

1380

реконструкция производственной линии для выпуска новых изделий радиационно стойкой электронной компонентной базы, необходимой для организаций Росатома и Роскосмоса**

169.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Восток", г. Новосибирск

133

90*

53

50

80

40

2010- 2011

1973

создание производственных мощностей по выпуску радиационно стойкой электронной компонентной базы в количестве 80-100 тыс. шт. в год для комплектования важнейших специальных систем**

170.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, г. Зеленоград

1520

760*

500

250

380

190

320

160

320

160

2012- 2015

5240***

техническое перевооружение завода для выпуска сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,18 мкм**

171.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт "Полус" им. М.Ф.Стеклова", г. Москва

240

120*

49,2

24,6

190,8

95,4

2010- 2011

1720

организация участка прецизионной оптической и механической обработки деталей для лазерных излучателей, твердотельных лазеров и бескарданных лазерных гироскопов нового поколения мощностью 442 шт. в год**

172.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Светлана", г. Санкт-Петербург

420

210*

110

55

100

50

105

52,5

105

52,5

2012- 2015

1555***

создание новых производственных мощностей для выпуска микроэлектронных датчиков физических величин и электронных датчиков для экспресс- контроля параметров крови и жизнедеятельности человека**

173.

Реконструкция и техническое перевооружение централизованного производства базовых несущих конструкций на федеральном государственном унитарном предприятии "Производственное объединение "Квант", г. Великий Новгород

166,2

150*

166,2

150

2009

7630,4

обеспечение потребности в базовых несущих конструкциях, в том числе импортозамещающих, предприятий приборостроения, машиностроения, судостроения и других отраслей промышленности**

174.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт электронно- механических приборов", г. Пенза

62

60*

62

60

2009

2404,6

техническое перевооружение действующего производства электронной компонентной базы и микросистемотехники для создания новых рядов конкурентоспособных изделий электронной техники**

175.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-

исследовательский институт электронной техники", г. Воронеж

60,1

30

60,1

30

2008

120

техническое перевооружение действующих производственных мощностей по выпуску сверхбольших интегральных схем и мощных сверхвысокочастотных транзисторов с объемом выпуска сверхбольших интегральных схем 50 тыс. шт. в год, мощных сверхвысокочастотных транзисторов 10 тыс. шт. в год**

176.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт физических проблем имени Ф.В.Лукина", г. Москва

160

80*

160

80

2012

700

организация серийного производства параметрических рядов мембранных датчиков мощностью 10 млн. шт. в год и чувствительных элементов для сканирующей зондовой микроскопии мощностью 0,3 млн. шт. в год**

177.

Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысокочастотного диапазона в открытом акционерном обществе "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область

840

420*

64

32

110

55

240

120

180

90

123

61,5

123

61,5

2010- 2015

12900

расширение производства перспективных тонкостенных антенно- фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысокочастотного диапазона, увеличение выпуска в 1,5 раза мощностью

44,76 тыс. шт. в год**

178.

Техническое перевооружение и реконструкция технологической и лабораторной базы производства и контроля перспективных радиоэлектронных модулей в открытом акционерном обществе "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск

1000

500*

300

150

280

140

210

105

210

105

2012- 2015

3225***

увеличение объемов производства модулей для обработки и передачи сигналов радиолокационных, навигационных и посадочных систем до 250 шт. в год**

179.

Техническое перевооружение и реконструкция производства и лабораторной базы для разработки и производства перспективных радиоэлектронных модулей, изделий в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва

1800

900*

560

280

500

250

370

185

370

185

2012- 2015

5455***

повышение эффективности, надежности и конкурентоспособности отечественных радиоэлектронных модулей, изделий, комплексов и систем открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега"***

180.

Техническое перевооружение и реконструкция производственно- технологической, контрольно- испытательной базы нового поколения антенных систем дистанционного зондирования Земли в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт "Кулон", г. Москва

1200

600*

360

180

340

170

250

125

250

125

2012- 2015

3870***

повышение надежности и качества конечной продукции открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", создание конкурентоспособных изделий мирового уровня, увеличение годового объема производства до 6 систем в год**

181.

Техническое перевооружение для создания производства нового поколения радиоэлектронных модулей в открытом акционерном обществе "Научно- производственное предприятие "Рубин", г.

Пенза

297,66

148,66*

47,66

23,66

110

55

140

70

2009- 2011

2456,4

создание комплексного испытательного стенда для исследования образцов техники мощностью 800 шт. в год**

182.

Техническое перевооружение производственно- технологической, контрольно- испытательной базы в открытом акционерном обществе "Инженерно- маркетинговый центр ОАО "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва

379,9

200*

25,9

23

70

35

80

40

60

30

72

36

72

36

2010- 2015

996,3

производство систем радиочастотной идентификации**

183.

Техническое перевооружение и реконструкция мощностей для производства микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса в открытом акционерном обществе "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск, Ярославская область

1000

500*

240

120

300

150

230

115

230

115

2012- 2015

3030***

обеспечение производства микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса в объеме до 1000 шт. в месяц**

184.

Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства прецизионных лазерных и пьезо- керамических гироскопов в открытом акционерном обществе "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика

1720

860*

500

250

480

240

370

185

370

185

2012- 2015

5200***

изготовление прецизионных лазерных и пьезокерамических гироскопов для перспективных летательных аппаратов**

185.

Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых элементов замены и модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

1220

610*

380

190

360

180

240

120

240

120

2012- 2015

3560***

изготовление унифицированных твердотельных низкочастотных типовых элементов замены для информационных средств и модулей активных фазированных антенных решеток для локационных систем различного применения, перспективных средств связи и управления воздушным движением**

186.

Реконструкция и техническое перевооружение производства унифицированных электронных модулей межвидового применения на открытом акционерном обществе "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно- исследовательский институт радиотехники", г. Нижний Новгород

720

360*

140

70

260

130

200

100

60

30

60

30

2011- 2015

9582

организация производства и внедрение современной технологии с соответствующим переоснащением высокопроизводительным оборудованием, увеличение объема ежегодного производства продукции с 2370 млн. рублей в 2007 году до 5028 млн. рублей в 2015 году**

187.

Техническое перевооружение специализированного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область

970

485*

240

120

277,62

138,81

240

120

106,19

53,095

106,19

53,095

2011- 2015

8442,7

увеличение объемов производства, повышение качества и надежности твердотельных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных антенных решеток L-диапазона для перспективных средств связи и управления воздушным движением**

188.

Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод", г. Москва

1230

615*

360

180

330

165

270

135

270

135

2012- 2015

4000***

увеличение объемов производства, повышение качества и надежности твердотельных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных антенных решеток С- и S-диапазонов волн для перспективных средств связи и управления воздушным движением**

189.

Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных высокочастотных типовых элементов замены в открытом акционерном обществе "Рязанский завод "Красное Знамя", г. Рязань

800

400*

240

120

200

100

180

90

180

90

2012- 2015

2425***

изготовление унифицированных твердотельных высокочастотных типовых элементов замены для локационных систем различного применения, перспективных средств связи и управления воздушным движением, увеличение объема производства типовых элементов замены в 1,5 раза**

190.

Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных рабочих мест операторов информационных систем в открытом акционерном обществе "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург

960

480*

260

130

240

120

230

115

230

115

2012- 2015

3300***

увеличение выпуска унифицированных автоматизированных рабочих мест операторов информационных и специального назначения управляющих систем в 1,7 раза**

191.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания регионального контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж

960

480*

300

150

240

120

210

105

210

105

2012- 2015

2800***

внедрение современных технологий с соответствующим переоснащением высокопроизводительным оборудованием для организации контрактного производства**

192.

Создание лабораторной, технологической и производственной базы для обеспечения разработки, производства и испытаний нового поколения телекоммуникационных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж

2060

1030*

640

320

560

280

430

215

430

215

2012- 2015

6000***

создание конкурентоспособной продукции мирового уровня, освоение технологий двойного назначения, увеличение объема выпуска изделий до 2 - 2,5 млрд. рублей в год**

193.

Реконструкция и техническое перевооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский электромеханический завод", г. Калуга

194,6

97,3*

194,6

97,3

2012

620***

создание мощностей по изготовлению спецтехники нового поколения, обеспечивающей защиту специальной информации в информационно- коммуникационных системах**

194.

Техническое перевооружение производства перспективных коротковолновых радиостанций в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов

57 0

285*

110

55

380

190

80

40

2011- 2013

3156

увеличение объема выпуска продукции в 1,3 - 1,5 раза, повышение качества и конкурентоспособности продукции**

195.

Реконструкция и техническое перевооружение производства наземной аппаратуры подвижной связи в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов

350

175*

90

45

80

40

90

45

90

45

2012- 2015

1200***

модернизация производства и внедрение современной технологии с соответствующим переоснащением высокопроизводительного оборудования**

196.

Техническое перевооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы в открытом акционерном обществе "Воронежский научно- исследовательский институт "Вега", г. Воронеж

600

300*

200

100

120

60

120

60

80

40

80

40

2011- 2015

2332,2

ускорение и повышение качества разработки мультисервисных сетей ведомственной и профессиональной связи, ожидаемый экономический эффект 3 млрд. рублей**

197.

Техническое перевооружение лабораторной и производственно- технологической базы нового поколения узлов связи в открытом акционерном обществе "Тамбовский научно- исследовательский институт радиотехники "Эфир", г. Тамбов

220

110*

220

110

2011

7500

ускорение и повышение качества разработки перспективных программно реализуемых сетей радиосвязи и серии унифицированных электронных модулей для построения указанных сетей**

198.

Техническое перевооружение производства открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва

915,4

457,7*

400

200

360

180

77,7

38,85

77,7

38,85

2012- 2015

2700***

серийное производство перспективной номенклатуры резисторов, в том числе чип-резисторов в объеме 350-400 млн. руб. в год**

199.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания серийного производства инфракрасных оптоэлектронных компонентов в открытом акционерном обществе "РЭ Комплексные системы", г.

Санкт- Петербург

720

360*

400

200

320

160

2012- 2013

2300***

серийное производство инфракрасных оптоэлектронных компонентов и комплекса электронных средств для обеспечения безопасности промышленных объектов**

200.

Техническое перевооружение с целью создания производства новых электровакуумных приборов на открытом акционерном обществе "Научно- производственное предприятие "Контакт", г. Саратов

161,5

136,5*

91,5

76,5

70

60

2009- 2010

2786

увеличение объемов производства в 1,5 раза** мощностью 4327 шт. в год

201.

Техническое перевооружение и реконструкция производства по выпуску электровакуумных приборов сверх- высокочастотного диапазона и специального технологического оборудования в открытом акционерном обществе "Владыкинский механический завод", г. Москва

178,375

150*

50,200

50

70,675

50

57,5

50

2008- 2010

2015

обеспечение увеличения объема выпуска продукции до 0,8 - 1,2 млрд. рублей в год, увеличения ресурса изделий, создания новых приборов мощностью 706 шт. в год**

202.

Техническое перевооружение для создания сборочного производства электронных модулей с использованием новейшей электронной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Электромеханический завод "Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область

800

400*

500

250

200

100

50

25

50

25

2012- 2015

2750***

создание сборочного производства с использованием микроминиатюрной элементной базы, в том числе микропроцессоров и матриц BGA**

203.

Реконструкция и техническое перевооружение с целью создания контрактного производства электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга

420

210*

140

70

100

50

90

45

90

45

2012- 2015

1450***

увеличение объема выпуска продукции до 520 млн. рублей в год**

204.

Техническое перевооружение и реконструкция производства и приборно- измерительной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Таганрогский научно- исследовательский институт связи", г. Таганрог

302

151*

80

40

70

35

76

38

76

38

2012- 2015

940***

внедрение современных технологий, создание комплекса для проведения контроля технологических параметров и испытаний. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза**

205.

Техническое перевооружение и реконструкция пилотной технологической линии по изготовлению наногетероструктурных сверхвысокочастотных транзисторов и монолитных интегральных схем для систем связи, измерительной техники, радиолокации и сверхвысокочастотной радиометрии в Учреждении Российской академии наук Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, г. Москва

480

240*

160

80

140

70

90

45

90

45

2012- 2015

1550***

производство наногетероструктурных сверхвысокочастотных транзисторов и монолитных интегральных схем для систем связи, измерительной техники, радиолокации и сверхвысокочастотной радиометрии**

206.

Техническое перевооружение и реконструкция производства испытательной базы нового поколения пьезо- электрических генераторов, фильтров, резонаторов в открытом акционерном обществе

"Завод "Метеор", г. Волжский, Волгоградская область

300

150*

80

40

70

35

75

37,5

75

37,5

2012- 2015

910***

производство полного функционального ряда массовых отечественных микроминиатюрных пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов. Увеличение объема выпуска продукции до 230-250 млн. рублей в год**

207.

Реконструкция и техническое перевооружение научно- производственной и лабораторной базы в открытом акционерном обществе "Ордена Трудового Красного Знамени федеральный научно- производственный центр по радиоэлектронным системам и информационным технологиям имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан

400

200*

120

60

120

60

80

40

80

40

2012- 2015

720***

расширение производственных площадей выпуска приемо-передающих модулей на 720 кв. м**

208.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе", г. Нижний Новгород

400

200*

120

60

120

60

80

40

80

40

2012- 2015

1540***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза**

209.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Омское производственное объединение "Иртыш", г. Омск

214,453 150*

79

60

135,453

90

2008- 2009

2300

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 2,5 раза**

210.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Авангард", г. Санкт- Петербург

300

150*

80

40

70

35

75

37,5

75

37,5

2012- 2015

1070***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,5 раза**

211.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства по изготовлению печатных плат выше 5-го класса точности и унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", г. Пенза

1000

500*

380,52

190,26

280

140

169,74

84,87

169,74

84,87

2012- 2015

3300***

обеспечение изготовления печатных плат с новыми финишными покрытиями до 20 000 кв. м в год;
обеспечение изготовления унифицированных электронных модулей на печатных платах в
количестве до 400 тыс. шт. в год**

212.

Техническое перевооружение и реконструкция производства электронных сверхвысокочастотных
модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский научно-
исследовательский приборостроительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород

600

300*

200

100

160

80

120

60

120

60

2012- 2015

1750***

внедрение современной технологии с соответствующим переоснащением высокопроизводительным
оборудованием. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза**

213.

Техническое перевооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств, защиты
информации на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский
институт автоматики", г. Москва

510

255*

210

105

160

80

70

35

70

35

2012- 2015

1645***

обеспечение разработки, производства и аттестации средств комплексов и систем защиты

информации. Увеличение объема выпуска продукции до 0,8 - 1,2 млрд. рублей**

214.

Техническое перевооружение и реконструкция регионального производства базовых несущих конструкций (БНК) на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследовательский институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону

300

150*

80

40

70

35

75

37,5

75

37,5

2012- 2015

935***

обеспечение потребности организаций в базовых несущих конструкциях для всех видов радиоэлектронной аппаратуры. Увеличение объема выпуска продукции в 2 раза**

215.

Реконструкция и техническое перевооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы для создания комплексов средств автоматизации информационно- управляющих систем на федеральном государственном унитарном предприятии "Ордена Трудового Красного Знамени научно- исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва

360

180*

90

45

90

45

90

45

90

45

2012- 2015

1060***

обеспечение разработки, производства и аттестации комплексов средств автоматизации информационно- управляющих систем. Увеличение объема выпуска продукции до 0,52 млрд. рублей**

216.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калугаприбор", г. Калуга

300

150*

80

40

70

35

75

37,5

75

37,5

2012- 2015

1250***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства
контрактной продукции в 1,8 раза**

217.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных
электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Ростовский-на-
Дону научно- исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону

300

150*

80

40

70

35

75

37,5

75

37,5

2012- 2015

1100***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства
контрактной продукции в 1,7 раза**

218.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных
электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Ордена Трудового
Красного Знамени научно- исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика
В.С.Семенихина", г. Москва

300

150*

80

40

70

35

75

37,5

75

37,5

2012- 2015

1060***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 2,5 раза**

219.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Курский завод "Маяк", г. Курск

300

150*

70

35

90

45

70

35

70

35

2012- 2015

970***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 2,5 раза**

220.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-исследовательский институт "Полус" имени М.Ф.Стедьмаха, г. Москва

400

200*

100

50

200

100

50

25

50

25

2012- 2015

1600***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза**

221.

Техническое перевооружение с целью создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-исследовательский институт телевидения", г. Санкт- Петербург

300

150*

100

50

100

50

50

25

50

25

2012- 2015

1210***

организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства
контрактной продукции в 1,7 раза**

222.

Техническое перевооружение с целью создания мощностей по выпуску источников вторичного электропитания в открытом акционерном обществе "Специальное конструкторско- технологическое бюро по релейной технике", г. Великий Новгород

240

120*

60

30

60

30

60

30

60

30

2012- 2015

1000***

увеличение объема производства в 1,5 раза**

223.

Реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной базы широкополосных сверх- высокочастотных устройств на федеральном государственном унитарном предприятии "Брянский электромеханический завод", г. Брянск

400

200*

100

50

140

70

80

40

80

40

2012- 2015

1210***

увеличение объема производства радиоэлектронных изделий на 170 млн. рублей**

224.

Техническое перевооружение и реконструкция производственно- испытательных мощностей на федеральном государственном унитарном предприятии "Государственное конструкторское бюро аппаратно- программных средств "Связь", г. Ростов-на-Дону

100

50*

100

50

2012

325***

увеличение объема выпуска продукции на 100 млн. рублей, освоение серийного производства изделий "Орион-ЗМ", "Орион-ЗСМ", "Анализ", "Страж-ПМ" и других**

225.

Техническое перевооружение и реконструкция научно- технического и производственного комплексов по выпуску электровакуумных приборов сверх- высокочастотного диапазона на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственное предприятие "Торий", г. Москва

800

400*

200

100

240

120

180

90

180

90

2012- 2015

2285***

увеличение объема выпуска продукции до 1,5 - 2 млрд. рублей в год, снижение себестоимости продукции**

226.

Техническое перевооружение и реконструкция регионального производства базовых несущих конструкций на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственное предприятие "Полет", г. Нижний Новгород

178,61

169,8*

102,6

100

76,01

69,8

2008- 2009

2010

увеличение объема выпуска продукции в 2 раза**

227.

Техническое перевооружение и реконструкция производства, метрологической и стендовой базы для

наноструктурированных материалов, слоистых структур и композитов на их основе в открытом акционерном обществе "Центральный научно- исследовательский технологический институт "Техномаш", г. Москва

480

240*

200

100

180

90

50

25

50

25

2012- 2015

1450***

организация производства базисных материалов и элементов для разработки приборов и устройств контроля сверхмалых количеств химических и биологических веществ с использованием наноструктурированных материалов, слоистых структур и композитов на их основе**

228.

Реконструкция и техническое перевооружение испытательного центра для обеспечения комплекса работ по корпусированию и испытаниям сложнофункциональных интегральных схем в открытом акционерном обществе "Российский научно- исследовательский институт "Электронстандарт", г.

Санкт- Петербург

400

200*

100

50

100

50

100

50

100

50

2012- 2015

1145***

увеличение объема производства изделий до 1,9 млн. шт. и 650 млн. рублей**

229.

Реконструкция и техническое перевооружение технологической линии по производству прецизионных многослойных печатных плат в открытом акционерном обществе "Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н.Г.Козицкого", г. Омск

700

350*

180

90

160

80

180

90

180

90

2012- 2015

1890***

увеличение объема выпуска продукции на 2 млрд. рублей**

230.

Реконструкция и техническое перевооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт "Экран", г. Самара

557,6

403*

113,5

110

108,4

88

115,7

95

220

110

2008- 2011

879

создание конкурентоспособных изделий мирового уровня. Разработка технологий двойного назначения. Увеличение объема производства в 1,5 раза**

231.

Реконструкция и техническое перевооружение производственно- технологической и лабораторной базы для комплексов специальной радиосвязи и управления на федеральном государственном унитарном предприятии "Омский научно- исследовательский институт приборостроения", г. Омск

714,7

360*

15,5

10,4

79,2

39,6

180

90

140

70

150

75

150

75

2010- 2015

3531

создание комплексов конкурентоспособной аппаратуры специальной радиосвязи и управления.

Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза**

232.

Реконструкция и техническое перевооружение моделирующего центра в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева", г. Москва

280

140*

70

35

70

35

70

35

70

35

2012- 2015

900***

повышение конкурентоспособности, снижение сроков разработки на 4-5 месяцев. Создание поведенческих моделей систем реального времени, использование систем поддержки принятия решений, проведение и анализ полунатурных испытаний, отработка алгоритмов искусственного интеллекта. Сокращение сроков испытания в 1,5 - 2 раза. Применение CALS- технологий с целью сокращения затрат и поддержки жизненного цикла разрабатываемых систем**

233.

Техническое перевооружение и реконструкция производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы по созданию модернизированной системы идентификации на федеральном государственном унитарном предприятии "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", г. Пенза

560

280*

160

80

170

85

115

57,5

115

57,5

2012- 2015

1650***

увеличение объема выпуска продукции до 421,5 млн. рублей**

234.

Техническое перевооружение и реконструкция метрологической, испытательной базы и производства оптических изделий на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский научно- исследовательский приборо- строительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород

600

300*

200

100

160

80

120

60

120

60

2012- 2015

1665***

создание метрологической, испытательной базы для разработки и производства контрольно-измерительной аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн. Увеличение объема производства квантовых рубидиевых стандартов частоты в 3 раза**

235.

Техническое перевооружение и реконструкция стендовой и испытательной базы сложных радио-электронных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Производственное объединение" Азимут", г. Махачкала, Республика Дагестан

190

95*

100

50

90

45

2012- 2013

633***

создание сверхширокополосных измерительных комплексов для измерения параметров одиночных антенн и линейных, плоских и объемных решеток систем навигации, посадки и радиолокации в ближней и дальней зонах (до 1000 м) и модернизация существующей в организации испытательной базы для проведения научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ**

236.

Техническое перевооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск

570

285*

70

35

140

70

120

60

120

60

120

60

2011- 2015

2000

увеличение объема выпуска продукции до 3 - 3,5 млрд. рублей в год**

237.

Техническое перевооружение и реконструкция производства сверхвысокочастотной техники на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород

1160

580*

73,24

36,62

280

140

320

160

243,38

121,69

243,38

121,69

2011- 2015

1500

увеличение объема производства монолитно- интегральных и гибридно-монолитных приборов и электронных компонентов (в том числе импортозамещающих) до 250 тыс. шт. в год, электровакуумных и вакуумно- твердотельных модулей (в том числе на основе микроминиатюрных ламп бегущей волны) до 1 тыс. шт. в год, унифицированных приемо-передающих модулей (в диапазоне частот 20 - 150 ГГц) до 1,5 тыс. шт. в год**

238.

Реконструкция и техническое перевооружение для выпуска теплоотводящих керамических подложек для твердотельных сверх- высокочастотных устройств и IGBT- модулей в открытом акционерном обществе "Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз", г. Новосибирск

224

112*

120

60

104

52

2012- 2013

4590***

увеличение объема выпуска продукции до 761,5 млн. рублей в год. Серийный выпуск электронных компонентов, керамических подложек, керамических корпусов, обеспечивающих увеличение объемов производства в различных отраслях промышленности, сверхвысокочастотной техники и силовой полупроводниковой электроники**

239.

Техническое перевооружение и реконструкция опытного приборного производства в открытом акционерном обществе "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург

640

320*

200

100

200

100

120

60

120

60

2012- 2015

1940***

реконструкция опытного производства с учетом реализации новых технологий по изготовлению интегральных сборок, датчиков на пьезопленках и других**

240.

Реконструкция и техническое перевооружение организации для совершенствования судовой электротехнической продукции в Федеральном научно- производственном центре открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Марс", г. Ульяновск

832

416*

200

100

240

120

196

98

196

98

2012- 2015

2450***

комплексное дооснащение базовых технологий производства электронных средств вычислительной техники с целью импортозамещения и повышения конкурентоспособности;
создание экспериментально- лабораторного комплекса для проведения контроля технологических параметров и испытаний**

241.

Реконструкция и техническое перевооружение опытно- экспериментального производства модулей функциональной микроэлектроники в открытом акционерном обществе "Концерн "Гранит - Электрон", г. Санкт- Петербург

240

120*

80

40

60

30

50

25

50

25

2012- 2015

800***

техническое перевооружение обеспечит:

внедрение современных технологий производства модулей функциональной микроэлектроники;

рост объема производства функциональных модулей в 2 - 2,5 раза;

расширение номенклатуры без существенных затрат на подготовку производства;

промышленное освоение технологий влагозащиты и электроизоляции модулей**

242.

Создание производственного комплекса для массового производства компонентов инерциальных микромеханических датчиков двойного назначения на федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно- исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург

1100

550*

280

140

270

135

275

137,5

275

137,5

2012- 2015

3250***

создание участков по производству кремниевых датчиков, многослойных плат, сборке и корпусированию инерциальных микромеханических изделий**

243.

Реконструкция инженерно- испытательного корпуса в открытом акционерном обществе "Концерн "Гранит - Электрон", г. Санкт- Петербург

620

310*

160

80

260

130

100

50

100

50

2012- 2015

2065***

внедрение современных базовых технологий производства электронных модулей цифровой и

цифроаналоговой вычислительной техники;
обеспечение разработки и производства базовых унифицированных электронных модулей.
Увеличение объема поставок до 10000 шт. в год**

244.

Техническое перевооружение производственно- технологического комплекса по созданию оптико-электронной компонентной базы на открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан

460

230*

80

40

70

35

155

77,5

155

77,5

2012- 2015

1705***

создание новой оптической элементной базы перспективных оптико-электронных систем, обеспечивающей предельно возможные технические параметры систем, в том числе комплексированных и многоспектральных оптических каналов**

245.

Реконструкция производственно- испытательного комплекса федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственная корпорация "Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт- Петербург

640

320*

160

80

200

100

140

70

140

70

2012- 2015

2000***

разработка, испытания, опытные поставки и серийное производство новых видов оптико-электронных систем, обеспечивающих предельно возможные технические параметры изделий**

246.

Реконструкция корпуса 2Ж для создания лабораторно- аналитического центра инфракрасной фото- и оптоэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва

700

350*

180

90

160

80

180

90

180

90

2012- 2015

2100***

создание единого аналитического центра по исследованиям и сертификации важнейших материалов и компонентов инфракрасной фотоэлектроники**

247.

Техническое перевооружение производственно- технологического комплекса по созданию оптоэлектронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "НПО "Орион", г. Москва

3720

1860*

1000

500

300

150

1210

605

1210

605

2012- 2015

12400***

создание производственно- технологического комплекса, который обеспечит промышленный выпуск изделий компонентной базы 2-го и 3-го поколений и оптико- электронных систем на их основе с параметрами, превышающими современный и прогнозируемый мировой уровень**

248.

Техническое перевооружение производственно- технологической базы в открытом акционерном обществе "Московский завод "Сапфир", г. Москва

600

300*

160

80

140

70

150

75

150

75

2012- 2015

2500***

создание инфракрасных матричных фотоприемных устройств нового поколения и организация на их основе производства тепловизионной аппаратуры широкого применения**

249.

Техническое перевооружение стендово- экспериментальной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт авиационного оборудования", г.

Жуковский, Московская область

420

210*

70

35

60

30

145

72,5

145

72,5

2012- 2015

1500***

обеспечение возможности проведения испытаний опытных образцов источников электроэнергии, статических преобразователей и аппаратуры защиты и коммутации для проекта "полностью электрический самолет"***

250.

Техническое перевооружение производственной базы, освоение инновационных технологий для изготовления радиоэлектронных изделий авиационной техники с использованием новых уровней технологий на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область

520

260*

140

70

120

60

130

65

130

65

2012- 2015

1900***

изготовление конкурентоспособных изделий авиационной техники, соответствующих современным и перспективным международным стандартам**

251.

Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально- технологической базы для производства микроэлектронных изделий в открытом акционерном обществе "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан

376

188*

70

35

60

30

123

61,5

123

61,5

2012- 2015

1175***

создание производственных мощностей по производству современной микроэлектронной аппаратуры**

252.

Реконструкция и техническое перевооружение цеха по производству первичных преобразователей и вторичной аппаратуры в открытом акционерном обществе "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан

230

115*

60

30

50

25

60

30

60

30

2012- 2015

695***

производство конкурентоспособной продукции, обладающей современными показателями по надежности, быстродействию и массогабаритным характеристикам**

253.

Реконструкция и техническое перевооружение производства электронных систем самолетного энергоснабжения в открытом акционерном обществе "Агрегатное конструкторское бюро "Якорь", г. Москва

458

229*

80

40

70

35

154

77

154

77

2012- 2015

1350***

серийное производство широкой номенклатуры статических преобразователей напряжения авиационных перспективных объектов (проект "полностью электрический самолет", истребитель 5-го поколения, программа развития гражданской авиационной техники)**

254.

Создание электронного полигона по исследованиям, отработке и сертификации бортового авиационного радиоэлектронного оборудования на федеральном государственном унитарном предприятии "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область

1070

535*

280

140

260

130

265

132,5

265

132,5

2012- 2015

4460***

полигон позволит проводить работы с радиоэлектронной аппаратурой в условиях реального полета с учетом информационного взаимодействия с наземными и самолетными системами обеспечения воздушного движения в реальных условиях естественных и промышленных помех**

255.

Создание центра сертификации аппаратных средств бортовой вычислительной техники на федеральном государственном унитарном предприятии "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", г. Москва

400

200*

100

50

100

50

100

50

100

50

2012- 2015

1300***

создание новой позиции для проведения сертификации аппаратных модулей бортовой вычислительной техники, включающей: аппаратное и программное оснащение центра сертификации;

создание и освоение базовых инженерных методик проведения сертификации;

акты ввода в эксплуатацию центра сертификации**

256.

Создание распределенной отраслевой стендово-имитационной среды исследований, отработки

прикладного математического обеспечения, отладки и испытаний систем и комплексов авиационного бортового радиоэлектронного оборудования на федеральном государственном унитарном предприятии "Государственный научно- исследовательский институт авиационных систем", г. Москва

500

250*

120

60

150

75

115

57,5

115

57,5

2012- 2015

1785***

создание распределенной информационно- связанной сети стендов, на которой будут проводиться исследования архитектур и информационных потоков, соответствующих различным условиям полета, интерфейсов, отработка системного и функционального математического обеспечения, отладка прикладного математического обеспечения и радиоэлектронной бортовой аппаратуры, наземные сертификационные испытания радиоэлектронных систем и комплексов**

257.

Техническое перевооружение производства в открытом акционерном обществе "Научно- производственный комплекс "Технокомплекс", г. Раменское, Московская область

1040

520*

260

130

240

120

270

135

270

135

2012- 2015

3850***

освоение: базовой конструкции фоточувствительных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для видимого и ближнего инфракрасного диапазона на основе применения отечественной электронной компонентной базы;

технологии создания фоточувствительных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для видимого и ближнего инфракрасного диапазона на основе применения отечественной электронной компонентной базы**

258.

Техническое перевооружение участков монтажа электронных систем и электронно- оптических модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Санкт- Петербургское опытно- конструкторское бюро "Электро- автоматика" имени П.А.Ефимова", г. Санкт- Петербург

296

148*

80

40

80

40

68

34

68

34

2012- 2015

1020***

ввод в эксплуатацию производственных линий с высокой степенью автоматизации производства современной авиационной радиоэлектронной и оптико-электронной аппаратуры для коммерческой и военной авиации**

2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования

259.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Пульсар", г. Москва, для создания межотраслевого базового центра системного проектирования

100

50*

100

50

2011

135,1

создание межотраслевого базового центра системного проектирования**

260.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Информационные телекоммуникационные технологии", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра полного цикла проектирования и производства аппаратно- программных комплексов

119,873 60

119,873

60

2008

1911

создание базового центра системного проектирования производительностью 40 аппаратно-программных комплексов в год**

261.

Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "систем в модуле" двойного и специального применения на открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт "Вектор", г. Санкт- Петербург

120

60*

120

60

2011

1324

обеспечение проектирования, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатические, механические, надежность и другие специализированные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по требованиям различных категорий заказчиков и производств**

262.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники", г. Москва, для создания базового центра проектирования

50

25*

50

25

2011

422,8

создание базового центра системного проектирования**

263.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, для создания базового центра проектирования

540

270*

80

40

460

230

2010- 2011

151,3

создание базового центра системного проектирования**

264.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт автоматики", г. Москва, для создания базового центра проектирования

35,37

30*

35,37

30

2009

493

создание базового центра системного проектирования**

265.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Восток", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования

140

70*

140

70

2011

599,85

создание базового центра системного проектирования**

266.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, для создания базового центра проектирования

182,3

100*

62,3

40

120

60

2010- 2011

700

создание базового центра системного проектирования**

267.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, для создания базового центра проектирования

130

100*

130

100

2010

998

создание базового центра системного проектирования площадью 998 кв. м**

268.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Ростовский- на-Дону научно- исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону, для создания базового центра проектирования

120,6

60*

120,6

60

2010

500

создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. м**

269.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Омский научно- исследовательский институт приборостроения", г. Омск (развитие базового центра системного проектирования СБИС)

17

17*

17

17

2008

500

создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. м**

270.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования

120

60*

120

60

2011

490

создание базового центра системного проектирования площадью 490 кв. м**

271.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Светлана", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования

232

116*

120

60

112

56

2012- 2013

800

создание базового центра системного проектирования площадью 800 кв. м**

272.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Центральный научно- исследовательский институт "Циклон", г. Москва, для создания базового центра проектирования

80

80****

80

80****

2010

800

создание базового центра системного проектирования площадью 800 кв. м**

272.1.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Государственный завод "Пульсар", г. Москва, для создания базового центра проектирования

200

100

200

100

2011

648

создание базового центра системного проектирования площадью 648 кв. м** мощностью 360 тыс. шт.

273.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт "Аргон", г. Москва, для создания базового центра проектирования

68,9

60*

68,9

60

2008

532

создание базового центра системного проектирования**

274.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "НПО "Орион", г. Москва, для создания базового центра проектирования

30

15*

15

7,5

15

7,5

2014- 2015

500

создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. м**

275.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полу-проводниковых приборов с ОКБ", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования

83,62

60*

83,62

60

2009

500

создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. м**

276.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт телевидения", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования

101,54

80*

101,54

80

2008

600

создание базового центра системного проектирования площадью 600 кв. м**

277.

Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования

140

70*

140

70

2011

600

создание базового центра системного проектирования площадью 600 кв. м**

278.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Нижегородский научно- исследовательский приборостроительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород, для создания базового центра проектирования

75,4

72,7*

75,4

72,7

2008

1097,8

создание базового центра системного проектирования**

279.

Техническое перевооружение и реконструкция открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область, для создания базового центра системного проектирования

1 04

80*

104

80

2008

650

создание базового центра системного проектирования площадью 650 кв. м**

280.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт "Экран", г. Самара, для создания базового центра проектирования

240

120*

240

120

2011

1134,5

создание базового центра системного проектирования площадью 1134,5 кв. м** мощностью 2000 шт.

281.

Создание базового центра проектирования на базе федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственная корпорация "Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт- Петербург

500

250*

130

65

160

80

105

52,5

105

52,5

2012- 2015

2000***

создание базового центра по проектированию, моделированию, изготовлению, тестированию и сертификации перспективных оптических систем и оптико-электронного оборудования**

282.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва, для создания базового центра проектирования систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передающих модулей

2200

1100*

590

295

520

260

545

272,5

545

272,5

2012- 2015

8800***

повышение качества и надежности систем цифровой обработки, систем твердотельных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных системных решеток С-диапазона для перспективных средств связи, управления воздушным движением и формирования сигналов на кристалле для радиолокационных станций различного применения**

283.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж

500

250*

192,38

96,19

120

60

93,81

46,905

93,81

46,905

2012- 2015

1925***

создание базового центра проектирования сложных функциональных блоков и сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" для нового поколения аппаратуры и мобильных телекоммуникационных систем;

создание конкурентоспособных изделий для нового поколения мобильных телекоммуникационных систем гражданского и двойного назначения**

284.

Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования (дизайн-центра) радиоэлектронных модулей и узлов стационарных и мобильных средств автоматизации в открытом акционерном обществе "Научно- производственное предприятие "Рубин", г. Пенза

440

220*

440

220

2011

1852

обеспечение производства комплексных средств автоматизации для управления автомобильным и железнодорожным транспортом, объектами топливно-энергетического комплекса**

285.

Создание базового центра системного проектирования унифицированных электронных модулей на основе современной электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе

"Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск

200

100*

90

45

110

55

2010- 2011

790

обеспечение возможности изготовления разработанных электронных модулей по современным технологиям;

повышение надежности и качества и ускорение разработки конкурентоспособных изделий мирового уровня;

разработка технологий двойного назначения**

286.

Создание базового центра системного проектирования унифицированных электронных модулей на основе современной электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область

119,7

100*

119,7

100

2010

750

обеспечение возможности изготовления разработанных электронных модулей по современным технологиям;

разработка технологий двойного назначения** мощностью 5 модулей в год

287.

Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "систем в модуле" двойного и специального применения на открытом акционерном обществе "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств", г. Калуга

180

90*

180

90

2011

640

обеспечение проектирования, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатические, механические, надежность и другие специализированные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по требованиям различных категорий заказчиков и производств**

288.

Создание базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "систем в модуле" двойного и специального применения в открытом акционерном обществе "Московский научно-исследовательский институт связи", г. Москва

30

30****

30

30****

2010

260

обеспечение проектирования, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатические, механические, надежность и другие специализированные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по требованиям различных категорий заказчиков и производств**

289.

Расширение базового центра системного проектирования по проектированию радиоэлектронной аппаратуры на базе сверхбольших интегральных схем "система на кристалле" в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва

320

160*

141,4

70,7

100

50

39,3 19,65

39,3

19,65

2012- 2015

1330***

расширение возможностей и объемов базового центра системного проектирования, перевод ключевых проектов, выполняемых концерном, на использование технологии современного системного проектирования. Ускорение процесса получения готовых проектов не менее чем в 2 раза**

290.

Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт "Кулон", г. Москва

210

105*

210

105

2011

773,5

обеспечение проектирования, производства высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей как ключевой технологии достижения высоких технических характеристик разрабатываемых и производимых изделий. Планируемый объем выпуска многокристальных модулей до 3,5 тыс. шт. в год **

291.

Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей в открытом акционерном обществе "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск, Ярославская область

165,6

105*

45,6

45

120

60

2010- 2011

350

обеспечение проектирования, производства высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей как ключевой технологии достижения высоких технических характеристик разрабатываемых и производимых изделий. Планируемый объем выпуска многокристальных модулей до 3,5 тыс. шт.**

292.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Московский ордена Трудового Красного Знамени научно- исследовательский радиотехнический институт", г. Москва, для создания базового центра проектирования универсальных цифровых устройств, комплексов и систем на базе современных лицензионных систем автоматизированного проектирования и технических средств

500

250*

250

125

250

125

2014- 2015

1600***

создание базового центра проектирования и разработки высокопроизводительных сверхбольших интегральных схем и микропроцессорной техники, оснащенного современными средствами проектирования, разработки и отладки сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле", а также матричных корпусов для сверхбольших интегральных схем с большим количеством выводов, контроллеров перспективных периферийных интерфейсов для разработки на их базе перспективных сложнофункциональных блоков и радиоэлектронной аппаратуры для систем и средств связи двойного и гражданского применения**

293.

Техническое перевооружение для создания базового центра проектирования универсальных микропроцессоров, систем на кристалле, цифровых приборов обработки сигналов и других цифровых устройств, комплексов и систем на базе современных лицензионных систем автоматизированного проектирования и технических средств открытого акционерного общества "Институт электронных управляющих машин им. И.С.Брука", г. Москва

170

125*

80

80****

90

45

2010- 2011

1530

создание базового центра разработки высокопроизводительной микропроцессорной техники двойного назначения, оснащенного современной технологией разработки многоядерных систем на кристалле, матричных корпусов для сверхбольших интегральных схем с большим количеством выводов, контроллеров перспективных периферийных интерфейсов для разработки на их базе высокопроизводительных вычислительных систем широкого применения**

294.

Техническое перевооружение и реконструкция базового регионального научно- технологического центра по микро- системотехнике федерального государственного унитарного предприятия "Омский научно- исследовательский институт приборостроения", г. Омск

840

420*

220

110

300

150

160

80

160

80

2012- 2015

2545***

ускорение проектирования и отработки технологии производства перспективных устройств микросистемотехники для комплектования аппаратуры управления, средств телекоммуникации и связи, высокоточного оружия, робототехнических комплексов, мониторинга окружающей среды, зданий и сооружений, систем трубопроводов, водо- и газоснабжения, цифровых и аналоговых устройств средств контроля, учета и дистанционного управления подачей энергоресурсов.

Ожидаемый экономический эффект составит 1500 млн. рублей**

295.

Реконструкция и техническое перевооружение центра системного проектирования и производства радиоэлектронных средств спутниковой связи федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственный центр "Вигстар", г. Москва

490

245*

120

60

160

80

105

52,5

105

52,5

2012- 2015

1635***

создание конкурентоспособных изделий мирового уровня двойного назначения для комплексов

аппаратуры спутниковой связи**

296.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов, с целью создания дизайн- центра и производства сверхвысокочастотных и силовых устройств

1080

540*

280

140

260

130

270

135

270

135

2012- 2015

2000***

создание дизайн- центра площадью 2000 кв. м и увеличение выпуска продукции на 500 млн. рублей в год**

297.

Техническое перевооружение для создания центра проектирования перспективной электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт электронной техники", г. Воронеж

89,1

45*

89,1

45

2008

189

создание конкурентоспособной технологии автоматизированного проектирования кристаллов сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле с проектными нормами 0,18 - 0,13 мкм и степенью интеграции до 100 млн. вентилях на кристалле, что позволит обеспечить ускоренную разработку сложнофункциональных блоков, сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле, соответствующих по техническим характеристикам современным мировым образцам**

298.

Создание отраслевого центра системного уровня проектирования интеллектуальных датчиков различного назначения на федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно- исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт- Петербург

340

170*

90

45

174

87

38

19

38

19

2012- 2015

1360***

организация современного центра системного уровня проектирования на основе отечественной электронной компонентной базы: микромеханических датчиков;

датчиков акустического давления;

датчиков угловых перемещений и других**

299.

Создание отраслевого центра проектирования сложных функциональных блоков и сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" в открытом акционерном обществе "Концерн "Моринформсистема-Агат", г. Москва

360

180*

90

45

135

67,5

135

67,5

2012- 2015

1385***

создание отраслевого центра проектирования (дизайн-центра) сложных функциональных блоков и сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" для обеспечения новейшей цифровой техникой приборостроительных организаций судостроительной отрасли**

3. Реконструкция и техническое перевооружение (включая приобретение программно-технических средств) для создания межотраслевого центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов

300.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская электроника", г. Москва (включая приобретение программно-технических средств), с целью создания межотраслевого центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов

724,95

590,75*

156

78

404,55

352,75

164,4

160

2008- 2010

375,5

создание межотраслевого центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов с объемом производства не менее 1200 шт. в год**

Итого по Минпромторгу России

70057,49

36710,41

1618,71

1267,7

1643,48

1412,71

2125,3

1695

5813,24

2906,62

18026,52

9013,26

15250

7625

12790,12

6395,06

12790,12

6395,06

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" (ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСАТОМ")

1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

301.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия
"Федеральный научно- производственный центр Научно- исследовательский институт
измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

196

98*

40

20

48

24

48

24

60

30

2010- 2013

267

создание технологического комплекса для производства сверхвысокочастотных монолитных
интегральных схем на широкозонных полупроводниковых материалах**

302.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства структур "кремний на
изоляторе" для субмикронных радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на
федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно- производственный
центр Научно- исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний
Новгород

440

220*

60

30

80

40

150

75

150

75

2012- 2015

1900***

создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

303.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства фотошаблонов субмикронных радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно- производственный центр Научно- исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

420

210*

80

40

100

50

120

60

120

60

2012- 2015

1700***

создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

304.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства структур "кремний на сапфире" с ультратонким приборным слоем для субмикронных радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно- производственный центр Научно- исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

380

190*

80

40

100

50

100

50

100

50

2012- 2015

1650***

создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

305.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства радиационно стойких изделий микроэлектроники с применением методов нанотехнологий на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследовательский институт автоматики", г. Москва

400

200*

100

50

100

50

100

50

100

50

2012- 2015

1850***

создание производственно- технологического участка изготовления изделий микроэлектроники для систем автоматики специзделий**

306.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства быстродействующих радиационно стойких монолитных интегральных схем на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно- производственный центр Научно- исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

952

476*

200

100

160

80

266

133

326

163

2012- 2015

2500***

создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

307.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства радиационно стойких изделий

оптоэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно-производственный центр Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

500

250*

100

50

120

60

140

70

140

70

2012- 2015

500***

создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

308.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства радиационно стойких изделий микросистемотехники на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно- производственный центр Научно- исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

780

390*

200

100

180

90

200

100

200

100

2012- 2015

800***

создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

309.

Техническое перевооружение и реконструкция с целью производства радиационно стойких изделий микроэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики", г. Саров, Нижегородская область

820

410*

192

96

180

90

224

112

224

112

2012- 2015

2544***

реконструкция производственно- технологических участков по изготовлению радиационно стойких изделий микроэлектроники**

2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования

310.

Реконструкция дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно- производственный центр Научно- исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород

200

100*

80

40

68

34

52

26

2008- 2011

2976

реконструкция дизайн- центра** мощностью 1 млн. транзисторов в год

311.

Реконструкция дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно- исследовательский институт автоматики", г. Москва

80

40*

20

10

40

20

20

10

2012- 2014

115,7***

реконструкция дизайн- центра**

312.

Реконструкция дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на

федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики", г. Саров, Нижегородская область

80

40*

20

10

40

20

20

10

2012- 2014

330***

реконструкция дизайн- центра**

313.

Реконструкция дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина", г. Снежинск, Челябинская область

100

50*

40

20

40

20

20

10

2012- 2014

300***

реконструкция дизайн- центра**

Итого по Госкорпорации "Росатом":

5348

2674

80

40

68

34

40

20

100

50

1140

570

1200

600

1360
680
1360
680

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (РОСКОСМОС)

1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

314.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно- космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, с целью создания производства многокристальных систем в корпусе, микро- и радиоэлектронных модулей, в том числе на основе устройств микросистемной техники

320
160*

110
55
105
52,5
105
52,5

2013- 2015

1230***

переоснащенное производство многокристальных систем в корпусе, микро- и радиоэлектронных модулей, в том числе на основе устройств микросистемной техники; оснащенное отраслевое автоматизированное хранилище производимых и приобретаемых электронных компонентов со встроенной системой мониторинга и прогнозирования состояния хранимой продукции**

315.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва, для создания производства модулей сверх- высокочастотных устройств для особо жестких условий эксплуатации

320
160*

200
100
60
30
60
30

2013- 2015

1120***

переоснащение производства по выпуску:

параметрического ряда модулей сверхвысокочастотных устройств;

узлов и крупноблочных радиоэлектронных функциональных модулей приемо- передающей аппаратуры.

Реализация указанных мероприятий обеспечивает:

сокращение сроков изготовления изделий радиолокационной техники и техники связи в 2-3 раза;

расширение номенклатуры сверхвысокочастотных изделий в 1,5 раза**

316.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железногорск, Красноярский край, с целью создания производственной линии для изготовления облегченных сверхвысокочастотных волноводов миллиметрового диапазона

160

80*

60

30

50

25

50

25

2013- 2015

590***

переоснащение производственной линии для выпуска облегченных сверхвысокочастотных волноводов;

увеличение производства сверхвысокочастотных волноводов с низким уровнем потерь и улучшенными массовыми характеристиками;

оснащение отраслевого автоматизированного хранилища для модулей радиоэлектронных и навигационных систем со встроенной системой мониторинга и прогнозирования состояния хранимой продукции**

317.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова", г. Екатеринбург, для создания производства электро- механических и радиоэлектронных компонентов микромодульных средств автономного управления и контроля

200

100*

80

40

60

30

60

30

2013- 2015

665***

дооснащение производства электромеханических и радиоэлектронных компонентов для микромодульных средств автономного управления и контроля;

увеличение производства изделий бортовой и промышленной радиоэлектроники на 35 процентов и более;

оснащение отраслевого автоматизированного хранилища для радиоэлектронных модулей со встроенной системой мониторинга и прогнозирования состояния хранимой продукции**

318.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Научно-

производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", г. Москва, для создания производства лазерных средств высокоточных измерений

580

290*

500

250

80

40

2012- 2013

600

переоснащение производства модульных лазерных средств высокоточных измерений, дальнометрии и передачи информации в бортовых и промышленных системах различного назначения**

319.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно- космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, для создания отраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы радиоэлектронной аппаратуры к дестабилизирующим факторам космического пространства

200

100*

80

40

60

30

60

30

2013- 2015

690***

создание межотраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы для специальной радиоэлектронной аппаратуры в условиях космического пространства, что обеспечит: внедрение технологических процессов прямого (в том числе неразрушающего) контроля стойкости электронной компонентной базы и экспериментально- аналитического прогноза деградации характеристик электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры; определение характеристик стойкости к условиям открытого космического пространства; увеличение сроков активного функционирования аппаратуры до 20 лет**

320.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Научно- производственный центр "Полюс" г. Томск, для технического перевооружения действующего производства

200

100*

80

40

60

30

60

30

2013- 2015

800***

переворужение производственных линий для изготовления встроенных модульных пассивных радиоэлементов для систем бортовой и промышленной радиоэлектроники и вторичных источников питания с совмещенными линиями передачи данных и электропитания; расширение номенклатуры и увеличение производства встроенных вторичных источников питания с совмещенными линиями передачи данных и электропитания для средств бортовой и промышленной электроники на 70 процентов и более**

321.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт микроприборов - К", г. Москва, для создания матричных оптико- электронных модулей на основе кремниевых мембран и гетеропереходов на основе арсенида галлия и нитрида галлия

200

100*

80

40

60

30

60

30

2013- 2015

770***

переоснащение производства матричных оптико-электронных модулей для работы в составе оптико-электронных преобразователей высокого разрешения и матричных сверхвысокочастотных приборов для модулей фазированных антенных решеток, что позволит:

расширить номенклатуру выпускаемой мелкосерийной продукции в 2 раза;

увеличить объем выпускаемых дискретных и модульных элементов в 10 раз**

2. Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования

322.

Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно- космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, для создания базового центра проектирования

726

363*

486

243

240

120

2012- 2013

500

создание базового центра системного проектирования площадью 3 500 кв. м**

323.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания отраслевого центра автоматизированного проектирования на открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва

914

461*

120

60

120

60

28

18

160

80

486

243

2008- 2012

500

создание отраслевого центра автоматизированного проектирования и функциональной поддержки процессов изготовления и эксплуатации параметрических рядов сверхвысокочастотных модулей унифицированных сверхвысокочастотных трактов, базовых несущих конструкций активных фазированных антенных решеток, радиолокационных и связных модульных приборов площадью 500 кв. м**

324.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра проектирования унифицированных микроэлектронных датчиков для работы в особо жестких условиях эксплуатации на открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт физических измерений", г. Пенза

280

140*

100

50

90

45

90

45

2013- 2015

380

создание центра проектирования унифицированных микроэлектронных датчиков площадью 380 кв. м для проектирования унифицированных полупроводниковых микродатчиков и преобразователей физических величин в системах управления, контроля и диагностики динамических объектов**

325.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования интегральных микроэлектронных датчиков и датчко- преобразующей аппаратуры на открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение измерительной техники", г. Королев, Московская область

200

100*

80

40

60

30

60

30

2013- 2015

350

создание базового центра площадью 350 кв. м для системного проектирования с полным циклом проектирования и производства параметрического ряда интегральных микроэлектронных датчиков и нанодатчиков для контрольной аппаратуры на основе специализированных электронных узлов по технологии "кремний на изоляторе" для особо жестких условий эксплуатации**

326.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра сквозного системного проектирования на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-производственное предприятие Всероссийский научно- исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г.Иосифьяна", г. Москва

160

80*

80

40

80

40

2014- 2015

450

создание базового центра сквозного системного проектирования и функциональной поддержки радиоэлектронных средств с улучшенной электромагнитной совместимостью площадью 450 кв. м (в том числе для создания встроенных бесконтактных систем управления электродвигателями и приводами, оптоэлектронных и радиотехнических приборов)**

327.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра проектирования на федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно- исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И.Берга", г. Москва

180

90*

100

50

40

20

40

20

2013- 2015

340

создание центра проектирования интегральных сверхвысокочастотных модулей специального и промышленного применения для унифицированных приема-передающих радиоэлектронных трактов

площадью 340 кв. м (в том числе для создания испытательного центра радиоэлектронной аппаратуры космического и промышленного назначения)**

328.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра проектирования матричных преобразователей и микроэлектронных сигнальных процессоров на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина", г. Москва

80

40*

40

20

40

20

2014- 2015

220

создание центра площадью 220 кв. м для системного проектирования матричных преобразователей и микроэлектронных сигнальных процессоров высокоточных навигационных приборов бортового и промышленного назначения**

329.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания центра проектирования особо стойкого модульного ядра отказоустойчивой радиоэлектронной аппаратуры с особо жесткими условиями эксплуатации на федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский институт "Комета", г. Москва

640

320*

140

70

500

250

2012- 2013

370

создание дизайн- центра площадью 370 кв. м для системного проектирования радиационно стойкой, помехоустойчивой электронной компонентной базы, в том числе изделий "система на кристалле" для построения особо стойкого модульного ядра радиоэлектронной аппаратуры с особо жесткими условиями эксплуатации, в том числе для космического, авиационного и промышленного применения**

330.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования и технического перевооружения действующего производства на открытом акционерном обществе "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железнодорожск, Красноярский край

148

74*

80

40

34

17

34

17

2013- 2015

300

создание базового центра сквозного системного проектирования и функциональной поддержки в процессе эксплуатации аппаратуры модульных средств связи и навигации для бортовых и промышленных систем площадью 300 кв. м**

331.

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра сквозного системного проектирования на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина", г. Химки, Московская обл.

200

100*

80

40

60

30

60

30

2013- 2015

350

создание базового центра сквозного системного проектирования и функциональной поддержки в процессе эксплуатации площадью 350 кв. м (в том числе для радиоэлектронных функциональных модулей роботизированных транспортных средств повышенной живучести)**

Итого по Роскосмосу

5708

2858

120

60

120

60

28

18

160

80

1612

806

1950

975

859

429,5

859

429,5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования

332.

Техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный институт электронной техники" (технический университет), г. Москва, для создания базового центра проектирования

78

54*

48

24

30

30

2009- 2010

515,1

создание базового центра системного проектирования площадью 515,1 кв. м**

333.

Реконструкция и техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики" (технический университет), г. Москва, для создания базового центра проектирования

50

25

50

25

2008

500

создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. м**

334.

Реконструкция и техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Томский государственный университет", г. Томск, для создания базового центра проектирования

200

100*

200

100

2012

400

создание базового центра системного проектирования площадью 400 кв. м**

335.

Реконструкция и техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана", г. Москва, для создания базового центра проектирования

200

100*

200

100

2013

400

создание базового центра системного проектирования площадью 400 кв. м**

336.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", г. Ростов- на-Дону, для создания базового центра проектирования

200

100*

200

100

2013

400

создание базового центра системного проектирования площадью 400 кв. м**

337.

Реконструкция и техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования

200

100*

100

50

100

50

2014- 2015

400

создание базового центра системного проектирования площадью 400 кв. м**

338.

Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт- Петербургский государственный университет", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования

230

115*

115

57,5

115

57,5

2014- 2015

600

создание базового центра системного проектирования площадью 600 кв. м**

Итого по Минобрнауки России

1158

594

50

25

48

24

30

30

200

100

400

200

215

107,5

215

107,5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ (ФСТЭК РОССИИ)

Реконструкция и техническое перевооружение действующих радиоэлектронных производств

339.

Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия

"Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск- Уральский, Свердловская область

200

100

66,76

33,38

133,24

66,62

2011- 2012

2000

создание новых производственных мощностей по выпуску оптоволоконных соединителей изделий
микромеханики**

Итого по ФСТЭК России

200

100

66,76

33,38

133,24

66,62

Итого по разделу II

82471,49

42936,41

1868,71

1392,7

1879,4

1530,71

2223,3
1763
6140
3070
21111,76
10555,88
18800
9400
15224,12
7612,06
15224,12
7612,06

* Размеры финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

*** Мощность объекта может быть уточнена на стадии разработки проекта.

**** Объемы скорректированы и полностью возвращены в бюджет.

Примечание: 1. Срок получения предусмотренных настоящим перечнем результатов работ соответствует году окончания их финансирования.

2. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 8 сентября 2011 г. № 763)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2008 - 2015 годы

В том числе

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего по Программе

106844,71

5372,7

5772,01

5400

13000

25580

19420

16537,94

15762,06

из них:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

91812,53

4757,7

5157,21

4952,62

11976,62

21733,26

15955

14005,06

13275,06

Федеральное космическое агентство

7008

290

320

168

430

2096

1815

939,5

949,5

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

6395,88

240

246,5

179,38

400

1424,12

1300

1325,88

1280

Министерство образования и науки Российской Федерации

1528,3

85

48,3
100
160
260
350
267,5
257,5

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

100

-

-

-

33,38

66,62

-

-

-

Капитальные вложения - всего

42936,41

1392,7

1530,71

1763

3070

10555,88

9400

7612,06

7612,06

из них:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

36710,41

1267,7

1412,71

1695

2906,62

9013,26

7625

6395,06

6395,06

Федеральное космическое агентство

2858

60

60

18

80

806

975

429,5

429,5

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

2674

40

34

20

50

570

600

680

680

Министерство образования и науки Российской Федерации

594

25

24

30

-

100

200

107,5

107,5

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

100

-

-

-

33,38

66,62

-

-

-

Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы - всего

63908,3

3980

4241,3

3637

9930

15024,12

10020

8925,88

8150

из них:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

55102,12

3490
3744,5
3257,62
9070
12720
8330
7610
6880

Федеральное космическое агентство

4150
230
260
150
350
1290
840
510
520

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

3721,88
200
212,5
159,38
350
854,12
700
645,88
600

Министерство образования и науки Российской Федерации

934,3
60
24,3
70
160
160
150
160
150

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 8 сентября 2011 г. № 763)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2008 - 2015 годы

В том числе

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего по Программе

179224,366

7903,837

8478,112

8267,417

21035

43629,41

33851,1

28632,37

27427,12

в том числе:

федеральный бюджет

106844,71

5372,7

5772,01

5400

13000

25580

19420

16537,94

15762,06

внебюджетные средства

72379,656

2531,137

2706,102

2867,42

8035

18049,41

14431,1

12094,43

11665,06

Капитальные вложения - всего

82471,49

1868,71

1879,48

2223,3

6140

21111,76

18800

15224,12

15224,12

в том числе:

федеральный бюджет

42936,41

1392,7

1530,71

1763

3070

10555,88

9400

7612,06

7612,06

внебюджетные средства

39535,08

476,01

348,77

460,3

3070

10555,88

9400

7612,06

7612,06

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего

96752,876

6035,127

6598,632

6044,117

14895

22517,65

15051,1

13408,25

12203

в том числе:

федеральный бюджет

63908,3

3980

4241,3
3637
9930
15024,12
10020
8925,88
8150

внебюджетные средства

32844,576
2055,127
2357,332
2407,117
4965
7493,53
5031,1
4482,37
4053".

7. В приложении № 5 к указанной Программе:

- а) абзац одиннадцатый дополнить словами "и Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования";
- б) в абзаце пятнадцатом цифры "18700" заменить цифрами "179224,366", цифры "110000" заменить цифрами "106844,71", цифры "77000" заменить цифрами "72379,66", цифры "64374,4" заменить цифрами "64554,9", цифры "125045,9" заменить цифрами "131640";
- в) в абзаце шестнадцатом цифры "198577,2" заменить цифрами "203443,4";
- г) в абзаце семнадцатом цифры "8,1" заменить цифрами "7,9";
- д) в абзаце восемнадцатом цифры "1,52" и "2,7" заменить соответственно цифрами "1,54" и "2,8";
- е) таблицы 1 - 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Показатели

2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

За расчетный период

Условно-переменная часть текущих издержек производства (себестоимости), процентов

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

-

Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж)

58000

70000

90000

110000

170000

210000

240000

270000

340000

420000

-

Инвестиции из всех источников финансирования по Программе

7903,837

8478,112

8267,417

21035

43629,41

33851,1

28632,37

27427,12

-

-

179224,366

в том числе:

средства федерального бюджета на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы,
капитальные вложения и прочие нужды

5372,7

5772,01

5400

13000

25580

19420

16537,94
15762,06
-
-
106844,71

из них:

капитальные вложения

1392,7
1530,71
1763
3070
10555,88
9400
7612,06
7612,06

-
-

42936,41

внебюджетные средства на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и др.)

2531,137
2706,102
2867,42
8035
18049,41
14431,1
12094,43
11665,06

-
-

72379,66

налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)

33000
34500
36000
38000
41000
46000
54000
60000
61000
62000

-

Рентабельность реализованной продукции, процентов

10

10
12
14
16
18
20
20
20
20
-

Амортизационные отчисления, процентов себестоимости

3,5
3,8
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
-

Материалы, процентов себестоимости

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-

Фонд оплаты труда, процентов себестоимости

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
-

24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
-

26
26
26
34
34
34
34
34

34

34

-

Налог на добавленную стоимость, процентов

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

-

Налог с продаж, процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Норма дисконта (средняя за расчетный период), процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

Таблица 2

Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Наименование показателей

Расчетный период

За расчетный
период

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

номер шага (m)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость

58000
70000
90000
110000
170000
210000
240000
270000
340000
420000

-

Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли

52727
63636
80357
96491
146552
177966
200000
225000

283333

350000

-

Прибыль от реализации продукции

5273

6364

9643

13509

23448

32034

40000

45000

56667

70000

-

Налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)

33000

34500

36000

38000

41000

46000

54000

60000

61000

62000

-

Налог на имущество

660

690

720

760

820

920

1080

1200

1220

1240

-

Налогооблагаемая прибыль

4587,3

5727,3

8967,9

12833,3

22744,8

31072,9
38800
43650
54966,7
67900

-

Налог на прибыль

1100,9
1145,5
1793,6
2566,7
4549
6214,6
7760
8730
10993,3
13580

-

Чистая прибыль

3486,3
4581,8
7174,3
10266,7
18195,9
24858,3
31040
34920
43973,3
54320

-

Амортизационные отчисления в структуре себестоимости

1845,5
2418,2
3214,3
4342,1
7327,6
9788,1
12000
14625
19833,3
26250

-

Материальные затраты в структуре себестоимости

26363,6
31818,2
40178,6

48245,6
73275,9
88983,1
100000
112500
141666,7
175000

-

Фонд оплаты труда в структуре себестоимости

13181,8
15909,1
20089,3
24122,8
36637,9
44491,5
50000
56250
70833,3
87500

-

Налог на добавленную стоимость

4745,5
5727,3
7232,1
8684,2
13189,7
16016,9
18000
20250
25500
31500

-

Налог с продаж

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подоходный налог

1713,6

2068,2
2611,6
3136
4762,9
5783,9
6500
7312,5
9208,3
11375
-

Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС

3427,3
4136,4
5223,2
8201,8
12456,9
15127,1
170000
19125
24083,3
29750
-

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)

10546,4
12631,8
15787
20781,9
31229,5
37848
42580
47887,5
60011,7
73865
353158,7

Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления)

5331,8
7000
10388,6
14608,8
25523,4
34646,4
43040
49545
63806,7
80570
-

Коэффициент дисконтирования (норма дисконта $E = 0,10$)

1
0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424

-

Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования

5331,8
6363,6
8585,6
10975,8
17432,9
21512,7
24295
25424,4
29766,3
34169,5
183857,6

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)

7903,8
8478,1
8267,4
21035
43629,4
33851,1
28632,4
27427,1

-

-

179224,366

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования

-2572,1
-1478,1
2121,2
-6426,2
-18106
795,3
14407,6
22117,9
63806,7

80570

-

Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования

7903,8

7707,4

6832,6

15803,9

29799,5

21018,9

16162,2

14074,4

-

-

119302,7

Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования

-2572,1

-1343,7

1753

-4828,1

-12366,6

493,8

8132,7

11350

29766,3

34169,5

64554,9

Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистый дисконтированный доход

-2572,1

-3915,8

-2162,8

-6990,9

-19357,5

-18863,7
-10730,9
619
30385,3
64554,9

-

Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,9

Индекс доходности (рентабельность инвестиций)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,54

Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства федерального бюджета на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы,
капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета)

5372,7

5772,01

5400

13000

25580

19420

16537,94

15762,06

-

-

106844,71

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды

10546,4

12621,8
15787
20781,9
31229,5
37848
42580
47887,5
60011,7
73865
353158,7

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

10546,4
11474,4
13047,1
15613,8
21330,2
23500,6
24035,3
24573,9
27995,9
31326
203443,4

Отток бюджетных средств

5372,7
5772
5400
13000
25580
19420
16537,9
15762,1

-
-
-

Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования

5372,7
5247,3
4462,8
9767,1
17471,5
12058,3
9335,2
8088,4

-
-

71803,33

Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования

5173,7
6227,1
8584,3
5846,7
3858,7
11442,3
14700,1
16485,4
27995,9
31326
131640

Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект

5173,7
11400,8
19985
25831,7
29640,4
41132,7
55832,8
72318,2
100314,1
131640
-

Индекс доходности бюджетных средств

2
2,2
2,9
1,6
1,2
1,9
2,6
3
-
-
2,8

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

10546,4
11474,4
13047,1
15613,8
21330,2
23500,6
24035,3
24573,9
27995,9

31226

203443,4

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

0,68

0,68

0,65

0,62

0,59

0,57

0,58

0,57

-

-

0,6

Период возврата бюджетных средств, лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 год

Уровень безубыточности

0,79

0,79

0,76

0,73

0,7

0,68

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,68

Таблица 3

Итоговые показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей)

Наименование показателей

2008 - 2017 годы

Всего инвестиций (в ценах соответствующих лет)

179224,366

в том числе:

средства федерального бюджета

106844,71

внебюджетные средства

72379,656

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход в 2017 году

64554,9

Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации, лет

7,9

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли

1,54

Уровень безубыточности

0,68

Показатели бюджетной эффективности

Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

203443,4

Бюджетный эффект

131640

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям

2,8

Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

0,6

Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям, лет

1 год".

8. В приложении № 6 к указанной Программе:

а) в разделе "Показатели коммерческой эффективности":

в абзаце двадцать третьем слова "13 процентов" заменить словами "8 процентов" и слова "15 процентов" заменить словами "10 процентов";

абзац двадцать четвертый исключить;

б) абзац четырнадцатый раздела "Показатели бюджетной эффективности" изложить в следующей редакции:

"страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 34 процентов фонда оплаты труда."